

**Всесоюзный
Центр
Переводов**

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ



МОСКВА • 1986

Государственный комитет СССР
по науке и технике

Академия наук
СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ

В помощь переводчику

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ

С о с т а в и т е л и
канд. техн. наук Н.А. Соболева, И.П. Вишневская

П о д р е д а к ц и е й
канд. физ.-мат. наук С.Х. Батыгова

Москва 1986

УДК 802.0=801.18:621.384

Ответственный редактор
И.И. Убин

© Всесоюзный центр переводов, 1986

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Данный выпуск содержит около 2 000 сокращений многословных терминов по электронным приборам, опубликованных в англоязычной технической литературе, и охватывает следующие разделы: электровакуумные приборы и их элементы, газоразрядные приборы, полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы, оптоэлектронные приборы – фотоприемники и полупроводниковые излучатели, в том числе полупроводниковые лазеры, индикаторные приборы, физические основы электронных приборов – электронная и ионная эмиссия, адсорбционные процессы, явления на поверхности твердого тела и методы диагностики поверхности, материалы электронной техники, методы их получения и контроля. Для большинства терминов даны русские эквиваленты, русские варианты сокращений приведены в тех случаях, когда соответствующие русские сокращения получили достаточно устойчивое применение. Замечания и предложения по содержанию выпуска просим направлять в адрес ВЦП: 117218, г. Москва, В-218, ул. Кржижановского, д. 14, кор. 1.

А

AA (active area) активная область	ACRT (accelerated crucible rotation technique) техника выращивания кристаллов с неравномерным /реверсивным/ вращением тигля
ABO (automatic beam optimizer) автоматический оптимизатор луча в установке электронолитографии	ACT (asymmetric crystal topography) асимметричная топография кристалла
ACED (alternate current electroluminescent display) электролюминесцентный индикатор в режиме переменного тока	ACTFEL (alternate-current thin film electroluminescent) тонкопленочная электролюминесцентная панель на переменном токе см. также ACCEL
ACFEL (alternate-current thin film electroluminescent) см. ACTFEL	AD (acceptor doping) легирование акцепторной примесью
ACEMS (angular conversion electron Mössbauer spectroscopy) угловая конверсионная мёсбауэровская спектроскопия (метод определения состава поверхности и глубинного профилирования)	ADES (angle dispersed electron spectroscopy) электронная спектроскопия с угловой дисперсией
ACMOS (advanced complementary MOS) улучшенный КМОП транзистор	ADP (ammonium dihydrogen phosphate) дигидрофосфат аммония
ACPTEL (alternate-current powder electroluminescent) электролюминесцентная панель с порошковым люминофором на переменном токе	ADT (alloy diffusion technique) диффузионное легирование из сплава
	AE (acoustic emission) акустическая эмиссия

AEAPS (Auger electron appearance potential spectroscopy)
спектроскопия потенциалов появления оже-электронов

AEPECS (Auger-electron-photoelectron coincidence spectroscopy)
см. APECS

AES (activation energy spectrum)
спектр энергий активации

AES-IM (AES+ion milling)
электронная оже-спектроскопия с послынным ионным травлением /фрезерованием/

A-IGFET (accumulation mode IGFET)
полевой транзистор с изолированным затвором в режиме накопления

AIM (avalanche-induced migration)
миграция, индуцированная лавинным процессом

ALE (atomic layer epitaxy)
эпитаксия атомарного слоя

ALS (advanced low-power Schottky)
улучшенная технология маломощных приборов с барьером Шоттки

AM 1(2) (air mass 1(2))
условия единичной /двойной/ воздушной массы /режим испытания солнечных элементов/

AMB-layer (antimeltback layer)
барьерный /предохраняющий/ против подтравливания подложки/ слой

AMC (asymmetry in modal confinement) laser
лазер с асимметричным распределением мод

AMD (alkali metal dispenser)
диспенсерный источник паров щелочных металлов

AM 0 (air mass Zero)
условия нулевой воздушной массы /режим испытания солнечных элементов/

AMS (accelerator mass-spectrometry)
масс-спектрометрия ускоренных /в циклотроне/ ионов

AND (alphanumeric display)
буквенно-цифровой дисплей

AOD (acousto-optic deflector)
акусто-оптический дефлектор

AOM (acousto-optic modulator)
акусто-оптический модулятор

AP (atom-probe)
атомный зонд

APECS (Auger-photoelectron coincidence spectroscopy)
оже-фотоэлектронная спектроскопия совпадений /реги-

страция оже- и фотоэле-
ктронов, эмиттируемых в
едином акте/
см. также AEPECS

APW (address path
width)
ширина адресной шины

APCVD (atmospheric
pressure CVD)
химическое осаждение из
паровой фазы при атмосферном давлении

APFIM (atom-probe
field-ion microscop)
автоэмиссионный ионный
микроскоп в режиме атом-
ного зонда

APS (appearance poten-
tial spectroscopy)
спектроскопия порогового
потенциала /потенциала
появления/

APS (atmospheric
plasma spraying)
плазменное струйное рас-
пыление при атмосферном
давлении

APW (augmented plane
wave)
метод усиленной плоской
волны

AR (antireflection)
противоотражающий

AR-technique (accelerat-
ed rotation technique)
техника выращивания кри-
сталлов при вращении
/тигля, заправки/ с уско-
рением

AR (angle resolved)
спектроскопия с угловым
разрешением

ARC (antireflection
coating)
противоотражающее покрытие

ARE (activated reacti-
ve evaporation)
активационное реактивное
напыление

AREDS (angle resolved
energy dispersive
spectroscopy)
энергодисперсионная спект-
роскопия с угловым разре-
шением

ARIES (angle resolved
ion-electron spect-
roscopy)
ионно-электронная спект-
роскопия с угловым разре-
шением

ARL (antistokes Raman
laser)
лазер на антистоксовом
комбинационном рассеянии

ARP (avalanche re-
sonant pump)
накачка на лавинной час-
тоте

ARP (angle-resolved
photoemission)
см. ARPES

ARPEFS (angle-resolved
photoemission extended
fine structure)
тонкая структура запоро-
гового спектра фотоэмис-
сии с угловым разрешени-
ем

ARPES (angle resolved photoemission spectroscopy)	ASPID (adsorption spectroscopy by polariton-induced desorption)
фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	адсорбционная спектроскопия, основанная на десорбции, индуцированной поляритонами /метод исследования адсорбционных систем/
см. также ARP	
ARSES (angle resolved secondary-electron spectroscopy)	AT (ambient temperature)
вторично-электронная спектроскопия с угловым разрешением	температура окружающей среды
ARUPS (angle resolved ultraviolet photoemission spectroscopy)	AT (avalanche transistor)
	лавинный транзистор
УФ-фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	ATE (anisotropic etch)
	анизотропное травление
ASE (amplified spontaneous emission)	ATT (accelerated test technique)
усиленное спонтанное излучение /суперлюминесценция/	метод ускоренных испытаний
ASES (arc source emission spectroscopy)	ATT (avalanche transit-time)
эмиссионная спектроскопия дугового источника	лавинопролетный
ASIC (application specific IC)	ATO (antimony-tin oxide)
ИС специфического применения	окись сурьмы-олова ($Sb_2O_3 + SnO_2$)
ASLEEP (automated scanning low-energy electron probe)	ATR (attenuated total reflection)
низкоэнергетический электронный зонд с автоматическим сканированием	нарушенное полное внутреннее отражение
	AVDP (automatic vacuum deposition)
	автоматизированная установка вакуумного осаждения

AZO (aluminium-doped zinc oxide)
оксид цинка, легированный алюминием /прозрачное проводящее покрытие/

B

BA-gauge (Bayard-Alpert) gauge
вакуумметр Байарда-Альперта

BAMBI (basic analyzer of MOS and bipolar devices)
программа фундаментального анализа МОП и биполярных приборов

BAMM (ballon-borne atmospheric mosaic measurement)
мозаичный измеритель атмосферного УФ излучения с ограниченным материалом баллона порогом

BANAN (barium-natrium niobat) $Ba_2NaNb_5O_{15}$
ниобат бария-натрия /НБН/ см. также BSH

BBAR (band-to-band Auger recombination)
межзонная оже-рекомбинация

BВН (buried-facet buried multi-hetero-structure)
скрытая многопереходная гетероструктура с зарощенной гранью

ВВНТ (ballistic bipolar heterojunction transistor)
баллистический биполярный гетеротранзистор

BBL (building-block layout)
метод проектирования СБИС на основе стандартных конструктивных блоков

BВМ (beam brightness modulation)
модуляция яркости луча

BBS (bucket-brigade structure)
структура типа пожарной цепочки

BC-laser (buried crescent laser)
лазерный диод со скрытой серповидной активной областью

BCC (body-centred cubic)
объемо-центрированная кубическая решетка /ОЦК/
BCD (bulk charge-transfer device)
прибор с объемным переносом заряда

BC LDD PMOS (buried channel lightly doped drain PMOS)
МОП ПТ со скрытым р-каналом и слаболегированной областью стока

BCM (buried coarctate mesa-structure)
скрытая встречная мезоструктура

BCS (buried crescent structure)
скрытая серповидная активная область

BCTC (bistable cholesteric twist cell)
бистабильная жидкокристаллическая ячейка на эффекте скручивания холестерической фазы

BDG (back-surface damage gettering)
геттерирование путем создания механически нарушенного слоя на тыловой поверхности

BDT (bidirectional transducer)
двумерный преобразователь ПАВ

BE (bound exciton)
связанный экситон
см. также BES

BEI (backscattered electron imaging)
получение изображения объекта в обратнорассеянных электронах

BER (beam equivalent pressure)
давление, эквивалентное плотности пучка молекул /в молекулярно-лучевой эпиксии/

BES (bond exciton state)
см. BE

BFET (bipolar-mode FET)
полевой транзистор в режиме биполярного

BFET (ballistic FET)
баллистический ПТ /с коротким каналом/ /БПТ/

BF(I) (bright-field image)
светлопольное изображение /в электронной микроскопии/

BGN (band-gap narrowing)
сужение запрещенной зоны

BGO ($\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$)
германат висмута /сцинтиллятор/

BGR (buried giga-ohm resistor)
структура со скрытым гигаомным резистором /ячейка памяти/

BHS (buried heterostructure)
см. BH

BH (buried heterostructure)
скрытая /зарощенная/ гетероструктура
см. также BHS

BIC (buried isolation capacitor)
конденсатор со скрытым изолирующим слоем

BICEPS (Bell IC engineering process simulation)
моделирование процесса производства ИС фирмы Белл

BIG (bundle-integrated-guide)
интегральная многоволноводная структура

BIPMOS (bipolar-MOS)
биполярная и МОП структуры на общей подложке

BIMPLOX (buried implanted oxide)
скрытый слой окисла, полученный ионной имплантацией

BIS (bremsstrahlung isochromatic spectroscopy)
спектроскопия изохроматического тормозного УФ-излучения /электрон-фотонная спектроскопия/
см. также UBIS, IPES, IPE

BJFET (bipolar junction FET)

ПТ с управляющим рп переходом

BJT (bipolar junction transistor)
планарный биполярный транзистор

BLIP (background-limited infrared photodetector)
приемник ИК излучения в режиме ограничения фоном /в ОФ-режиме/

BLE (bombardement-induced light emission)

оптическое излучение, индуцированное ионной /электронной/ бомбардировкой

BLIP (background-limited performance)
режим ограничения фоном /ОФ-режим/

BMH-laser (buried multi-heterostructure laser)

лазерный диод со скрытой многопереходной гетероструктурой

BMQW (buried multi-quantum well)

скрытая многослойная структура с квантовыми ямами

BN (boron nitride)
нитрид бора

BOG (buried optical guide)
скрытый /зарощенный/ оптический волновод

BO-MOS (buried-oxide MOS)
МОП-структура со скрытым слоем изолирующего окисла

BPBT (ballistic permeable-base transistor)

баллистический транзистор с проникаемой базой

BPSG (borophosphor-silicate glass)
боро-фосфорносиликатное стекло

BRI (Bragg reflection imaging)
электронография брэгговского отражения

BRS (backscattering Rutherford spectroscopy)
спектроскопия обратного резерфордского рассеяния быстрых ионов
см. также RBS

BRSL (buried ridge structure laser)
лазерный диод со скрытой
реберной структурой

BS (backscattering spectrometry)
спектрометрия обратно-рас-
сеянных частиц

B-S-technique (Bridg-
men-Stockbarger tech-
nique)
метод выращивания моно-
кристаллов Бриджмена-
Стокбаргера

BSF (back-surface field)
поле, встроенное у тыловой
поверхности /солнечного
элемента/

BSIS (broad-channeled substrate inner stripe)
/лазерный диод/ с широким
встроенным полосковым ка-
налом в подложке

BSITIC (bipolar static induction transistor IC)
интегральная микросхема
на биполярных транзисторах
со статической индукцией

BSN (barium-sodium niobat) $Ba_2NaNb_5O_{15}$
см. BANAN

BSR-contact (back sur-
face reflection con-
tact)
тыловой отражающий контакт
/в солнечных элементах/

BT (bipolar transistor)
биполярный транзистор

BN-stress aging (bias-
temperature stress
aging)
термополеовое старение

BTRS (buried twin-ridge substrate)
скрытая двойная реберная
структура в подложке

BTT (breakdown-tempe-
rature test)
температурные испытания
при пробивном напряже-
нии

BTT (base transit time)
время пролета через ба-
зовую область

B-U-electron gun (bi-
potential-unipotential electron gun)
гибридная /бипотенциаль-
ная-унипотенциальная/
электронная пушка

BV (bias voltage)
напряжение смещения

BV (breakdown voltage)
напряжение пробоя

BW (bandwidth)
ширина /частотной/ поло-
сы

BW CMOS (bi-well CMOS)
КМОП структура с двойным
карманом /"карман в кар-
мане"/

BWM (backward-wave magnetron)
лампа обратной волны
М-типа

BWO (backward-wave oscillator)
 см. BWT
 BWT (backward-wave tube)
 лампа обратной волны /ЛОВ/
 см. также BWO
 BZ (Brillouin zone)
 зона Бриллюэна

C

CACRT (Czochralski accelerated crucible (and crystal) rotation technique)
 метод Чохральского с неравномерным вращением тигля /и кристалла/
 CADIC (computer-aided design of IC)
 машинное проектирование ИС
 CAIBE (chemically assisted ion beam etching)
 ионно-лучевое травление с химическим действием
 CAM (computer-aided manufacturing)
 гибкое автоматизированное производство /ГАП/
 см. также CAT
 CAMFET (camel gate field effect transistor)
 ПТ с затвором на пьедестале

CAND (colour alphanumeric display)
 цветной буквенно-цифровой дисплей
 CARIS (constant angle reflection interference spectroscopy)
 интерференционная спектроскопия при постоянном угле отражения
 CARS (coherent anti-stokes Raman scattering)
 когерентное антистоксово комбинационное рассеяние света /КАРС/
 CASFET (cascode MOSFET)
 внутренняя каскадная схема на МОП ПТ с коротким скрытым каналом
 CAT (computer-aided technology)
 см. CAM
 CAT (cooled anode tube)
 электронная лампа с охлаждаемым анодом
 CB (conduction band)
 зона проводимости
 CB (common base)
 общая база
 CB (controlled birefringence)
 управляемое двулучепреломление
 CBV (conduction band bottom)
 дно зоны проводимости

CBC (collector-base current)	CCC (corrugated capacitor cell)
ток коллектор - база	гофрированный конденсатор
CBC (common base circuit)	CCC (C ³) (cleaved coupled cavity)
схема с общей базой	связанный по сколу резонатор
CBD (convergent beam diffraction)	CCD (cold cathode discharge)
дифракция сходящегося пучка	разряд с холодным катодом
CBE (chemical beam epitaxy)	CCD (charge carriers depletion)
химическая лучевая эпитаксия /комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений/	обеднение носителями заряда
см. также MO-MBE	CCD (charge carrier density)
CBED (convergent beam electron diffraction)	концентрация носителей заряда
дифракция сходящегося пучка электронов	CCD (custom circuit design)
CBFS (caesium beam frequency standard)	разработка заказных ИС
цезиевый стандарт частоты	CCF (circular core fiber)
CBU (coefficient of beam utilization)	оптическое волокно с круглым сердечником
коэффициент использования луча	CCI (charge carrier injection)
CC (common collector)	инжекция носителей заряда
общий коллектор	CCIRID (charge coupled infrared imaging device)
CC (chip carrier)	преобразователь ИК-изображения на ПЗС
кристаллодержатель, подложка	CCM (charge carrier mobility)
CCA (chip-by-chip alignment)	подвижность носителей заряда
покристальное совмещение	CCM LD (current confinement mesa-substrate laser diode)
	лазерный диод с ограничением тока на меза-подложке

CCNI (current-controlled negative inductance)	CCTWT (coupled-cavity TWT)
управляемая током отрицательная индуктивность	лампа бегущей волны со связанными резонаторами
CCP (chrome circuit pattern)	CD (climbing dislocation)
хромовый фотошаблон	переползающая дислокация
CCP (cross-connecting point)	CD (chip density)
точка перекрестного соединения	плотность упаковки /в ИС/
CCR (C^2R) (charge control ring)	CL (co-deposited)
кольцеобразная защитная структура, ограничивающая распространение зарядов в силовом транзисторе	полученный совместным осаждением
CCRT (cathodochromic cathode-ray tube)	CDA (cylindrical deflector analyser)
ЭЛТ с катодохромным экраном	цилиндрический энергоанализатор с отклонением пучка
CCSR (charge coupled shift register)	CDD (charge domain device)
регистр сдвига на ПЗС	прибор на зарядовых доменах /на эффекте Ганна/
CCT (crystal cutting technique)	CDD (concentration-dependent diffusion)
техника разрезания кристалла	концентрационно-зависимая диффузия
CCT (conductivity controlled transistor)	CDF (charge domain filter)
транзистор с управляемой проводимостью	фильтр на зарядовых доменах
CCTC (capillary channel type conductivity)	CDH-laser (constricted double heterojunction laser)
проводимость, зависящая от сечения канала	двойной гетеролазер с ограничением
	CDL (characteristic diffusion length)
	характеристическая длина диффузии

CDS (capacitor-diode storage)	CEPIC-process (complementary epitaxial passivated IC process)
диодно-конденсаторное ЗУ	технология комплементарных эпитаксиальных пассивированных ИС
CDS (comprehensive display system)	CER (cost-efficiency ratio)
дисплейная система с высоким качеством отображения	отношение стоимость/эффективность
CDT (chip design technique)	CERMET (ceramic-metal)
метод проектирования микросхем	кермет
CDW (charge density wave)	CERP (carbon fibre reinforced plastics)
волна плотности заряда	пластмасса, армированная угольным волокном
CEC (common emitter circuit)	CES (controllable emitter shorts thyristor)
схема с общим эмиттером	тиристор с управляемым шунтированием эмиттера
CEF (complementary emitter follower)	CEV (collector-emitter voltage)
эмиттерный повторитель на КМОП структурах	напряжение коллектор-эмиттер
CEL (contrast enhanced lithography)	CF (conversion factor)
контрастная литография	коэффициент преобразования
CELS (characteristic energy loss spectroscopy)	CF (cathode follower)
спектроскопия характеристик потерь энергии /электронов/	катодный повторитель
CEM (channel electron multiplier)	CFA (crossed-field amplifier)
канальный электронный умножитель /КЭУ/	СВЧ усилительная лампа со скрещенными полями /М-типа/
CEMA (channel electron multipliers array)	
матрица канальных электронных умножителей	

CFEM (crossed field electron multiplier)
электронный умножитель со скрещенными полями
см. также CFM

CFET (charge field-effect transistor)
зарядовый полевой транзистор

CFI (crystal frequency indicator)
кварцевый индикатор частоты

CFM (crossed field multiplier)
см. CFEM

CFP (crossed-field photomultiplier)
см. CFPM

CFPM (crossed-field photomultiplier)
фотоэлектронный умножитель /ФЭУ/ со скрещенными полями
см. также CFP

CFS (constant final-state spectroscopy)
электронная спектроскопия в условиях постоянства конечных состояний

CFT (charge-flow transistor)
транзистор с растеканием носителей заряда

CG (cathode grid)
катодная сетка

CG (control grid)
управляющая сетка

CG (cross-gate) CCD
ПЗС с перекрестными затво-

рами /затворы в нижнем и верхнем слоях на окисной изоляции расположены горизонтально и вертикально/

CGI (compressed-gas insulation)
изоляция сжатым газом

CHA (concentric hemispherical analyzer)
концентрический полусферический энергоанализатор

CHE (channel hot electron)
/инжекция/ горячих электронов из канала

CHEMFET (chemical FET)
полевой хемотранзистор /электрохимический ПТ/

CHIC (ceramic hybrid IC)
гибридная ИС на керамической подложке

CHIP (chip hermeticity in plastic)
герметизация пластмассой

CMOS III (complementary high-performance MOS-III)
технология масштабированных КМОП ИС высокого качества III поколения /с n-карманом/

CMOS (complementary hybrid MOS)
гибридная КМОП структура / комбинация E/D CMOS + E/E CMOS /
см. также HCMOS

СНТ (CdHgTe)
теллурид кадмия-ртути

ChVs (chalcogenide
vitreous semiconductor)
халькогенидный стеклооб-
разный полупроводник

CIBE (cluster ion beam
evaporation)
напыление /пленок/ с ис-
пользованием пучка ионных
кластеров

CIBL (conventional ion-
beam lithography)
традиционная ионно-лучевая
литография

CIC (compatible IC)
совместимая ИС

CIC (consume IC)
потребительская ИС

CIC (custom IC)
заказная ИС

CID (compositional
interdiffusion)
метод взаимной диффузии

CID (collector insu-
lation diffusion)
коллекторная изолирующая
диффузия /КИД/

CID (charge image
device)
устройство отображения на
зарядовых приборах

CID (controlled inver-
sion device)
прибор с управляемой ин-
версией

CIG (chemical ion
generator)
химический ионный источ-
ник

CII (channeled ion
implantation)
направленная ионная им-
плантация

CIM (charge imaging
matrix)
матричный зарядовый пре-
образователь изображения

CIS (constant initial-
state spectroscopy)
электронная спектроскопия
в условиях постоянства
начальных состояний

C-LEC (computer-cont-
rolled liquid encap-
sulation Czochralski)
метод Чохральского с жид-
костной герметизацией с
управлением от ЭВМ

CLS (characteristic
loss spectroscopy)
см. CELS

CMA (cell memory
array)
матричное ЗУ

CMF (contrast modula-
tion function)
частотно-контрастная ха-
рактеристика /ЧКХ/
см. также MTF

CMR (contact microradiography)
автордиография

CMS (compositionally
modulated structure)
структура из материала с
модуляцией состава

CMT (conjunction-mask
technique)
метод сопряжения масок
/в технологии ИС/

CNS (channeled-substrate narrow stripe)	CPD (contact potential difference)
узко-полосковая структура с каналом в подложке	контактная разность потенциалов /КРП/
CO (crystal oscillator)	CPE (composition pulling effect)
кварцевый вибратор	эффект вытягивания состава
см. также XO	
COD (catastrophic optical damage)	CPM (channel-plate multiplier)
катастрофическое оптическое разрушение	электронный умножитель с микроканальной пластиной
COG (chip on glass)	CPM (channel photo-multiplier)
технология ИС на стеклянной подложке	канальный фотоумножитель
COMFET (combined FET)	CPM-laser (colliding-pulse mode-locked laser)
силовой ПТ, изготовленный по комбинированной МОП и биполярной технологии	лазер с модулированной добротностью на встречных пучках
COMFET (conductivity modulated FET)	CR (cyclotron resonance)
мощный МОП ПТ с модулированной проводимостью /с повышенной путем инжекции неосновных носителей проводимостью n -области стока/	циклотронный резонанс
COS (colour separation)	CRD-cathode (cavity-reservoir dispenser cathode)
цветоделительный	распределительный катод с запасом эмиссионного вещества
CP (ceramic package)	CRIS (cyclotron resonance ion source)
керамический корпус	ионный источник на основе циклотронного резонанса
CPAA (charged particle activation analysis)	CRN (continuous random network) model
активационный анализ с возбуждением заряженными частицами	непрерывная хаотичная сетка /модель структуры аморфного материала/

Cross-MOS-transistor	CSD (charge sweep device)
ПТ с двумя затворами с до- полняющими каналами на каждой поверхности ре- кристаллизованного слоя поликремния /для снижения эффекта короткого канала/ см. также XMOS	прибор с вытягиванием за- рядов
CRT (charactron tube) характрон, ЭЛТ с матрич- ным экраном знаков	CSE (charge storage element)
CRTM (cathode ray tube memory)	элемент с накоплением за- ряда
ЗУ на ЭЛТ	CSL (coincident site lattice)
CRYEBIS (cryogenic electron-beam ion source)	решетка совпадающих узлов
ионный источник с элект- ронно-лучевой ионизацией и со сверхпроводящим магнитом	CSOS (complementary silicon on sapphire)
CS (circular scanning) круговая развертка	комплементарная ИС, изго- товленная по технологии "кремний-на-сапфире"
CSA (coaxial-to-strip adapter)	CSP (channeled-sub- strate planar)
коаксиально-полосковое соединение	планарный /лазерный диод/ с каналом в подложке
CSBH (channeled-sub- strate buried hetero- structure)	CSP (chemical spray pyrolysis)
скрытая гетероструктура с каналом в подложке	пиролиз пульверизованно- го раствора
CSC (crossed strip cryotron)	CSSD (chemically sen- sitive semiconductor device)
плечный криотрон со скрещенными полосковыми электродами см. также CFC	хемочувствительный полу- проводниковый прибор
	CSVТ (close space vapour transport)
	газовый транспорт при близком расположении ис- точника и подложки
	CTC (conductive trans- parent coating)
	прозрачное проводящее покрытие
	см. также TCC

CTDM (charge transfer diode memory)
ЗУ на приборах с переносом заряда

CTO (cadmium-tin oxide)
оксид кадмия-олова

CTO (conductive transparent oxide)
прозрачный проводящий окисел

CTR (chemical transport reaction)
химическая транспортная реакция /ХТР/

CTS (current-transient spectroscopy)
спектроскопия переходного тока

CTT (carrier transit time)
время пролета носителей заряда

CTT (cartridge type transistor)
транзистор в корпусе в виде патрона

CUJT (complementary unijunction transistor)
комплементарная схема на однопереходных транзисторах

CV-method (capacitance-voltage method)
метод вольт-фарадных характеристик /ВФХ/

CVE (critical voltage effect)
эффект критического напряжения /в просвечивающем электронном микроскопе/

CVP (controlled vapour pressure)
регулируемое давление пара

CVT (chemical vapor transport)
химический паровой транспорт

CW (continous wave)
непрерывный режим излучения

CWIC (custom-wired IC)
ИС со специальной разводкой /потузаказная ИС/

CZS (CZ-silicon)
кремний, выращенный по методу Чохральского

D

DA (diode array)
диодная матрица

DA (donor-acceptor)
см. DAP

DAHC-MOSFET (drain avalanche hot carrier MOSFET)
МОП-транзистор с лавинным умножением горячих носителей в области стока

1DAL (2DAL, 3 DAL) (one (two, three)-dimensional active layer)
/лазерный диод/ с одномерным /дву-, трехмерным/

активным слоем /с кванто-
во-размерным эффектом/

DAP (donor-acceptor
pair)

донор-акцепторная пара
/ДАП/

см. также ДА (donor-accep-
tor

DAP-transistor (diffus-
ed alloy power tran-
sistor)

мощный диффузионно-сплав-
ной транзистор

DAPS (disappearance
potential spectroscopy)
спектроскопия потенциала
отсечки

DAR (double avalanche
region)

область с двумя лавинными
процессами

DAR IMPATT (double
avalanche region
IMPATT)

ЛПД с двумя лавинными об-
ластями /двухлавинный
ЛПД/

DAZD (double anode
Zener diode)

стабилитрон с двойным ано-
дом

DBD (double-base
diode)

двухбазовый диод

DBS (direct broad-
casting sattelit)

прямое спутниковое веща-
ние

DBS (dielectric break-
down strength)

электрическая прочность
диэлектрика

DBT (depleted base
transistor)

биполярный транзистор с
обедненной базой

DC (dual-control-
gate)

/полевой транзистор/ с
двойным управляющим за-
твором

DC-laser (double-chan-
nel laser)

двухканальный лазерный
диод

DC (driver cell)

ячейка формователя

DC (directional
coupler)

направленный ответвитель

DCBH (double-channel
buried heterostruc-
ture)

скрытая гетероструктура
с двойным каналом /в под-
ложке/

DCC (double current
confinement)

двойное ограничение тока
/в лазерном диоде/

DCD (double-crystal
X-ray diffractometry)

рентгеновская дифракто-
метрия на двух кристаллах

DCDS (direct current
diode sputtering)

метод диодного катодного
распыления на постоянном
токе

DCFEM (dynamic crossed field electron multiplier)

динамический электронный умножитель со скрещенными полями

DCM (double channel mesa-structure)
двухканальная меза-структура

DCPBH (double-channel planar buried heterostructure)
планарная скрытая гетеро-структура с двойным каналом /в подложке/

DCPDP (direct current plasma display panel)
газоразрядная индикаторная панель постоянного тока

DC PEL (direct current powder electroluminescent)
электролюминесцентная /панель/ с порошковым люминофором на постоянном токе

DC TFEL (direct current thin film electroluminescent)
тонкопленочная электролюминесцентная /панель/ на постоянном токе

DD (donor doping)
легирование донорной примесью

DDD (double diffused drain)
/транзистор/ с областью стока, образованной двойной диффузией

DD IMPATT (double drift IMPATT)
двухпролетный ЛПД в режиме ударной лавины

DDLTS (double-correlation DLTS)
релаксационная спектроскопия глубоких уровней с двойной коррекцией /корреляцией/

DDM (double-diffused mesa)
меза-структура с двойной диффузией

DD-MOS (deep depletion MOS)
МОП структура с глубоким обеднением

DDR (double drift region)
пространство двойного дрейфа /в ЛПД/

DDR (dry developed resist)
резист с сухим проявлением

DDS (doped deposited silica)
кварц, легированный в процессе осаждения

DDS (dual-level double-lift-off substitutional-gate)
замена материала электрода затвора с помощью двухслойного резиста и двухкратной взрывной технологии /при изготовлении быстродействующих ИС на GaAs /

DDT (double-diffused transistor)	DET (double-emitter transistor)
транзистор, изготовленный методом двойной диффузии	двухэмиттерный транзистор
2D-E (two-dimensional electron gas)	DET (domain extinction time)
см. 2DEG, TEG	время распада домена
DEAP (diffused eutectic aluminium process)	DEZn (diethylzinc)
процесс диффузии в область базы при плавлении эвтектики Al-Si путем пропуска обратного тока	диэтилцинк
DEBWL (direct electron beam on wafer lithography)	DF (dark-field)
электронолитография с непосредственным получением изображения на пластине	темнопольное изображение /в электронной микроскопии/
2DEG (two-dimensional electron gas)	DF (dislocation-free)
двумерный электронный газ	бездислокационный
см. также 2D-E, TEG	DFA (double filter analyzer)
DEM (double-exposure method)	энергоанализатор с двойным фильтром
метод двойной экспозиции	DFD(L) (distributed feedback dye laser)
DEP (dry etching process)	лазер на красителях с распределенной обратной связью
процесс сухого травления	D-FET (depletion-mode FET)
DES (dry etching system)	ПТ в режиме обеднения
установка сухого травления	DFPS (double floating probes system)
DES (de-excitation spectroscopy)	система с двумя плавающими зондами
деактивационная спектроскопия	DFR (dry film resist)
	пленочный резист сухого проявления
	DFTS (dispersive Fourier transform spectroscopy)
	дисперсионная фурье-спектроскопия

DG (diode gate)
диодный вентиль

DG (double-groove)
структура с двойной канавкой

DGC (drain-gate capacitance)
емкость промежутка сток-затвор

DG/DP (double groove/
double petticoat)
двойная канавка/двойная
изолирующая юбка

DGS (density of gap states)
плотность состояний в за-
преженной зоне

DGTET (dual gate thin
film transistor)
тонкопленочный транзистор
с двойным затвором

2D-H (two-dimensional
hole gas)
см. 2DHG

DHBT (double heterojunc-
tion-bipolar tran-
sistor)
биполярный транзистор с
двойным гетеропереходом

DHC (directly heated
cathode)
катод прямого накала

D-HEMT (depletion-
mode HEMT)
транзистор с высокой по-
движностью электронов в
режиме обеднения

2DHG (two-dimensional
hole gas)
двумерный дырочный газ
см. также THG

DHL (double hetero-
structure laser)
см. DHLD

DHLD (double hetero-
structure laser
diode)
лазерный диод с двойной
гетероструктурой, двойной
гетеролазер
см. также DHL

DI (degree of integ-
ration)
степень интеграции

DI (double carrier
injection)
двойная инжекция носите-
лей

DIBL (drain-induced
barrier lowering)
понижение барьера под воз-
действием стока

DIBS (dual-ion-beam
sputtering)
распыление /мишени/ двой-
ным ионным пучком

DIC (dual-in-line
ceramic)
керамический корпус с
двухрядным расположением
выводов

DICMOS (diode-clocked
MOS)
МОП инвертор с диодом в
качестве прерывателя

DID (diffusion-induced
dislocations)
дислокации, введенные в
процессе диффузии

DIGBM (diffusion-induced grain-boundary migration)
индуцированная диффузией миграция границ зерен

D-IGFET (depletion-mode insulated-gate field effect transistor)
ПТ с изолированным затвором в режиме обеднения

DIMOS (double injection MOS)
МОП структура с двойной инжекцией

DIMPATT (distributed IMPATT)
ЛПД с распределенными параметрами

DIRCOUP (directional coupler)
направленный ответвитель

DIW (deionized water)
деионизованная вода

DJ (deep junction)
глубокий переход

DJI (diffused junction isolation)
изоляция диффузионным рп переходом

DL (defect level)
уровень дефекта

DL (depletion layer)
обедненный слой

DL (dielectric layer)
слой диэлектрика

DL (deformation luminescence)
деформационная люминесценция

DL (delay line)
линия задержки

DL (double LOCOS)
двухэтапное локальное окисление

DLC (diamond-like carbon)
алмазоподобный углерод

DLD (dark line defect)
дефект типа темной линии

DLFS (deep level Fourier spectroscopy)
Фурье-спектроскопия глубоких уровней

DLHJ (double-layer heterojunction)
двухслойный гетеропереход

DLOS (deep level optical spectroscopy)
оптическая спектроскопия глубоких уровней

DLPT (double-level polysilicon technique)

двухуровневый поликремниевый процесс

DLR (double-layer resist)
/литография/ с двухслойным резистом /двухслойное маскирование/

DLT (depletion load transistor)
нагрузочный транзистор в режиме обеднения

DM (diffused mesa)
диффузионная меза-структура

DMD (depletion-mode device)
прибор в режиме обеднения

DMOS (discrete MOS)
дискретный МОП ПТ

D-MOS (depletion mode MOS)
МОП структура в режиме обеднения

DMPX (demultiplexer)
демультиплексор
см. также DMX

DMS (diluted magnetic semiconductor)
разбавленный магнитный полупроводник

DMT (depletion-mode transistor)
транзистор в режиме обеднения

DMX (demultiplexer)
см. DMPX

DMXO (dual-mode quartz crystal oscillator)

двухмодовый кварцевый вибратор

DmZn, (dimethylzinc) (DMZn)
диметилцинк

DLTS (deep level transient spectroscopy)

релаксационная спектроскопия глубоких уровней /РСГУ/

DOFIC (domain-originated functional IC)
функциональная ИС на эффекте Ганна

DOS (density of states)
плотность состояний

DOVATT (double velocity avalanche transit time)
ЛПД с двумя дрейфовыми областями

DP (diode plate)
диодная пластина

DPC (differential photocurrent)
метод измерения дифференциальной фотопроводимости

DPF (dense plasma focus)
мощная плазменная пушка

DPR (dry processed resist)
резист сухого проявления

DPT (Darlington power transistor)
монolithicный усилительный каскад /схема Дарлингтона/ на двух транзисторах

DPT (diffused planar transistor)
диффузионный планарный транзистор

DQE (differential quantum efficiency)
дифференциальная квантовая эффективность

DQW (double quantum well)
структура с двумя квантовыми ямами

DRIFT (diffuse reflection IR Fourier transform)
Фурье-спектроскопия диф-

фузного отражения ИК
излучения

DSC (differential
scanning calorimetry)
дифференциальная скани-
рующая калориметрия
/ДСК/

DSD (dark-spot
defect)
дефект типа темной точки

DSE (dynamic scatter-
ing effect)
эффект динамического рас-
сеяния
см. также DSME

DSI (double Schottky
interdigitated)
/фотоприемник/ с двойным
встречно-штыревым /гре-
бенчатым/ электродом Шот-
тки

DSIMS (dynamic SIMS)
динамическая вторично-
ионная масс-спектрометрия

DSL (doping super-
lattice)
легированная сверхрешетка
/образованная слоями n-
и p-типа проводимости/

DSM (dynamic single-
mode)
динамический одномодовый
режим генерации

DSME (dynamic scatter-
ing mode effect)
см. DSE

DSMSL (dynamic single-
mode semiconductor
laser)
полупроводниковый лазер в

динамическом одномодовом
режиме

DSPE (double SPE)
двукратная твердофазная
эпитаксия

DSRD (drift step reco-
very diode)
диод со скачкообразным
/очень быстрым/ восста-
новлением

DSSF (double-sided
surface field)
двухстороннее приповерх-
ностное встроенное поле

DSW (double Si-
wiring)
двухуровневая поликрем-
ниевая разводка

DSWL (direct step-on-
wafer lithography)
литография с помодульной
фотомультипликацией пря-
мо на пластину

DSWP (direct step-on-
wafer processing
(printing))
процесс прямого переноса
топологического рисунка
на пластину
см. также DSWT

DSWT (direct stop-on-
wafer technique)
см. DSWP

DT (diffusion transis-
tor)
диффузионный транзистор

DT (discharge tube)
разрядник

DIC (deposition thickness controller)
регулятор толщины осаждаемого слоя

DTCXO (digital temperature compensated quartz crystal oscillator)
кварцевый вибратор с цифровой температурной компенсацией

DIFT (depletion-mode TFT)
тонкопленочный транзистор в режиме обеднения

DUVCP (deep UV contact printing)
контактная фотолитография на глубоком /жестком/ УФ излучении /190-250 нм, разрешение < 0,5 мкм/

DUVL (deep UV lithography)
фотолитография на глубоком /жестком/ УФ излучении /190-250 нм, разрешение < 0,5 мкм/

D-V-MOS (double-diffusion V-MOS)
МОП структура с V-образной канавкой, полученная методом двойной диффузии

D-V-MOS (double-implanted V-MOS)
МОП структура с V-образной канавкой, полученная методом двойной ионной имплантации

DWE (direct wafer exposure)
прямое формирование рисунка на пластину

DWEBL (direct writing electron-beam lithography)
электронолитография с прямой записью топологического рисунка

DWSREBE (direct writing step-and-repeat electron-beam exposure)

прямое электронно-лучевое экспонирование с мультипликацией

DX (donor-vacancy complex)
комплекс донор-вакансия

Е

EA (electroabsorption)
электропоглощение /эффект Франца-Келдыша/

EAF (electron-arc furnace)
электронно-дуговая печь

EAL (electromagnetic amplifying lens)
электромагнитная усиливающая линза

EAMOS (electrically alterable MOS)
электрически перепрограммируемая ИС на МОП-транзисторах

EAP (electroabsorption avalanche photodiode)

лавинный фотодиод с электропоглощением /с использованием эффекта Франца-Келдыша/

EAPEs (extended appearance potential fine structure)
тонкая структура протяженного спектра потенциала появления

EB (emitter-base)
промежуток эмиттер - база

E-B (emitter-base)
переход эмиттер - база

EBAL (electron-beam array lithography)
матричная электронолитография

EBB (electron-beam bonding)
электронно-лучевая сварка

EBCVD (electron beam assisted chemical vapour deposition)
химическое осаждение из паровой фазы с электронно-лучевой стимуляцией

EBDSL (electron-beam direct-stepping-on-wafer lithography)

электронолитография с проекцией топологического рисунка непосредственно на пластину

EBE (electron beam evaporation)
электронно-лучевое напыление

EBCS (electron-beam controlled switch)
переключатель, управляемый электронным лучом

EBE (electron beam exposure)

электронно-лучевое экспонирование

EBG (electron-beam gun)
электронно-лучевой прожектор

EBIV (electron beam induced voltage)
наведенное /электронным лучом/ напряжение

EBM (electron beam melting)
электронно-лучевая плавка

EBME (electron beam metal evaporation)
электронно-лучевое испарение металла

EBMF (electron beam microfabricator)
электронно-лучевой микроманипулятор /в электронолитографии/

EBP (electron-beam proximity printing)
электронно-лучевая контактная печать

EBP (etch-back process)
процесс вытравливания канавки в подложке с последующим ее заполнением

EBR (electron beam remelting)
электронно-лучевая переплавка

EBR (electron beam resist)
электронорезист

EBS (electron beam scanning)
электронно-лучевое сканирование

EB6 (energy band structure)
структура энергетической зоны

EBSР (electron back-scattering pattern)
изображение в обратнорассеянных электронах /в РЭМ/

EBSР (electron beam slice printer)
установка для электронолитографии на пластине

EBT (emitter balast transistor)
транзистор с балластным резистором в цепи эмиттера

EBT (electron beam technology)
электронно-лучевая технология

EBW (electron beam welding)
электронно-лучевая сварка

EC (electron capture)
захват электронов

EC (emission current)
эмиссионный ток

ECC (etched coupled-cavity)
связанный резонатор, полуженный травлением

ECD (energy conversion device)
преобразователь энергии

ECDCT (electrochemical diffused collector transistor)
электрохимический транзистор диффузионным коллектором

ECF (electroconductive film)
электропроводящая пленка

ECF (elliptical core fiber)
оптическое волокно с эллиптическим сердечником

ECL (external cavity laser)
лазер с внешним резонатором

ECO-laser (embedded confining-layer on optical guide laser)
лазерный диод со встроенным ограничивающим слоем на волноводе

ECP (electron channelling pattern)
картина каналирования электронов /в РЭМ/

ECR (electron cyclotron resonance)
электронный циклотронный резонанс

ECRH (ECR-heating)
нагрев с помощью электронного циклотронного резонанса

ECR-IS (ECR ion source)
ионный источник с разогревом плазмы электронным циклотронным резонансом

ECR-PD (ECR plasma deposition)
метод плазменного осаждения с использованием электронного циклотронного резонанса

ECS (electron capture spectroscopy)
спектроскопия электронного захвата

ED (epitaxial deposition)
эпитаксиальное нанесение

E/D (enhancement/depletion)
режим обогащения/обеднения

EDB (electrodless direct bounding)
безвыводный прямой доступ

EDC (energy distribution curves)
кривые энергетического распределения

E/D CMOS (enhancement/depletion) CMOS
КМОП структура в режиме обогащения/обеднения

EDD (electron discharge device)
электровакuumный прибор

EDFF (edge-defined film-fed)
см. EFG

E/D MOSFET (enhancement/depletion) MOSFET
МОП транзистор, работающий в режиме обогащения/обеднения

EDOE (energy distribution of output electrons)
энергетическое распределение эмиттированных электронов

EDOS (electronic density of states)
плотность электронных состояний

EDP (ethylene diamine pyrocatechol)
этилендиаминпирокатехин

EDP (electron diffraction pattern)
электронограмма

EDS (energy dispersive spectroscopy)
энергодисперсионная спектроскопия

EDT (electron display tube)
индикаторная ЭЛТ

EDX(A) (energy dispersive X-ray analysis)
энергодисперсионный рентгеновский анализ

EDXRF (energy-dispersive X-ray fluorescence)
энергодисперсионная рентгеновская флуоресцентная /спектроскопия/

E/E CMOS (enhancement/enhancement) CMOS
КМОП структура в режиме обогащения/обогащения

EED (emitter edge dislocations)
дислокации на границе эмиттера

EED (electron energy distribution)
энергетическое распределение электронов

EE (electron emission)
электронная эмиссия

EE (exoelectron emission)
экзоэлектронная эмиссия

EE (edge effect)
краевой эффект

EEDF (electron energy distribution function)
функция энергетического распределения электронов

EEIC (elevated electrodes IC)
ИС с приподнятыми электродами

EELD (edge emission laser diode)
лазерный диод, излучающий с торца

EELED (edge emission LED)
светодиод, излучающий с торца

EEM (emission electron microscope)
эмиссионный электронный микроскоп

EF (evaporated film)
напыленная пленка

E-FET (enhanced FIT)
ПТ в режиме обогащения

EFG (electron field gradient)
градиент электрического поля

EFG (edge-defined film-fed growth)
выращивание ленточного кремния с использованием формообразователя с капиллярной щелью /модификация метода Степанова/ см. также EDFF

EFZ (encapsulation floating zone)
зонная плавка с жидкостной герметизацией

EG (electron gun)
электронная пушка

EGS (epitaxially grown silicon)
эпитаксиальный кремний

EHD (electron-hole droplets)
электронно-дырочные капли

EHD-ion source (electrohydrodynamic ion source)
электрогидродинамический ионный источник

E-HEMT (enhancement-mode HEMT)
транзистор с высокой подвижностью электронов в режиме обогащения

EHL (electron-hole liquid)
электронно-дырочная жидкость

ENP (electron-hole pair)
электронно-дырочная пара

ENP (electron-hole plasma)
электронно-дырочная плазма

EI (end injection) краевая инжекция	EL (electroluminescence) электролюминесценция
EIA (extended-interaction amplifier) СВЧ усилитель с протяженным взаимодействием	EL (electron-trap label) обозначение электронной ловушки /EL 2 - основной глубокий донорный уровень в нелегированном GaAs /
EID (electron induced (impact) desorption) электроностимулированная десорбция	ELA (electron linear accelerator) динейный ускоритель электронов
EIES (electron impact emission spectroscopy) эмиссионная спектроскопия при электронном возбуждении	ELAC (electroacoustic) электроакустический
EIK (extended-interaction klystron) клистрон с протяженным взаимодействием	ELC (electroluminescent chamber) электролюминесцентная /ионизационная/ камера
EIL (electron-injection laser) электронно-инжекционный лазер	ELEED (elastic low energy electron diffraction) дифракция медленных упруго отраженных электронов
EIMS (electron impact mass-spectrometry) масс-спектрометрия электроностимулированной десорбции	ELD (electroluminescent display) электролюминесцентный индикатор
EIO (extended-interaction oscillator) СВЧ генератор с протяженным взаимодействием	ELIC (electrophotographic light-scanned image converter) электрофотографический преобразователь изображения с оптическим сканированием
EISS (elastic ion scattering spectroscopy) спектроскопия упругого рассеяния ионов	ELIN (electronic lamp ion noise) ионный шум электронной лампы

ELIPS (electron image projection system)
система электронно-лучевого экспонирования

ELO (epitaxial lateral overgrowth)
боковое эпитаксиальное наращивание /разрашивание/

ELSICON (electroluminescent-layer sandwich image converter)
твердотельный преобразователь изображения /ТПИ/ с электролюминесцентным слоем

ЕМ (electron microscope, electron microscopy)
электронный микроскоп, электронная микроскопия

ЕМ (electron mobility)
подвижность электронов

EMAT (electromagnetic acoustic transducer)
преобразователь акустических колебаний в электромагнитные

ЕМВН (etched-mesa buried heterostructure)
скрытая мезаполосковая гетероструктура, полученная химическим травлением

EMDA (ellipsoidal mirror display-type analyzer)
эллипсоидальный зеркальный энергоанализатор с выходом на дисплей

EMIS (electromagnetic isotope separator)
электромагнитный разделитель изотопов

EML (embedded-mirror semiconductor laser)
полупроводниковый лазер со встроенным зеркалом см. также EMS

ЕММ (electron mirror microscope)
зеркальный электронный микроскоп см. также МЕМ

EMMA (electron mask making apparatus)
аппаратура для электронно-лучевого изготовления масок

EMMA (electron microscopy and microanalysis)
электронная микроскопия и микроанализ

EMP (electromagnetic pulse)
импульс электромагнитного излучения

EMP (electron microprobe)
электронный микрозонд

EMS (embedded-mirror semiconductor) laser
см. EML

EMSD (evaporated metal-semiconductor diode)
диод Шоттки с напыленным слоем металла

EMT (electron multiplier tube)
электронный умножитель

EOLM (electrooptical light modulator)	EPM (electron probe microanalysis)
электрооптический модулятор света	электронно-зондовый микроанализ
EOM (electro-optic modulator)	EPS (electrochemical photocapacitance spectroscopy)
электрооптический модулятор	электрохимическая фото-емкостная спектроскопия
EOS (electrical overstress)	EPT (epitaxial planar transistor)
перенапряжение	эпитаксиальный планарный транзистор
EP (etch pit)	EQE (external quantum efficiency)
ямка травления	внешняя квантовая эффективность
EP (epitaxial planar) эпитаксиальная планарная структура	ER (electroreflectance) электроотражение
EPD (etch pit density)	ER (explosive recrystallization)
плотность ямок травления /мера плотности дислокаций/	взрывная рекристаллизация
EPD (electrode pattern definition)	ER (electron resist) электронорезист
формирование рисунка электродов	ER (exposing radiation) экспонирующее излучение
EPD (electro-phoretic display)	ERD (elastic recoil detection)
электрофорезный индикатор	спектроскопия атомов отдачи /при упругих соударениях быстрых ионов/
EPIC (etched polycrystalline-carried IC)	ERM (evaporate rate monitor)
изоляция ИС с помощью поликремния в вытравленной канавке	регулятор скорости напыления
EPL (electron projection lithography)	ERW (etched ridge waveguide)
проекционная электронолитография	вытравленный реберный волновод

ES (electron spectroscopy)
электронная спектроскопия

ES (emission spectroscopy)
эмиссионная спектроскопия

ESA (electron-stimulated adsorption)
электроностимулированная адсорбция

ESA (electrostatic analyser)
электростатический энергоанализатор

ESBI (equivalent screen background input)

входной сигнал, эквивалентный фоновому свечению экрана /в ЭОП/

ESD (electrostatic damage)
электростатическое повреждение

ESD (electrostatic discharge)
электростатический разряд

ESDI (electron stimulated desorption of ions)
электроностимулированная десорбция ионов

ESDIAD (electron stimulated desorption of ions, angular distribution)
угловое распределение электроностимулированной десорбции ионов

ESEM (environmental scanning electron microscope)
растровый электронный микроскоп, могущий работать в условиях повышенного давления или влажности

ESF (electrostatic focusing)
электростатическая фокусировка

ESFK (electrostatically focused klystron)
клистрон с электростатической фокусировкой

ESGL (embedded stripe geometry laser)
лазер со встроенной полосковой геометрией

ESI (electron spectroscopic imaging)
отображение электронных спектров

ESP (edge-supported-pulling) process
метод вытягивания с фиксированными краями

ESR-Si (edge-stabilized ribbon-Si)
ленточный кремний, полученный методом Степанова /профилированием с использованием формователя/

ESS (electronic scanning system)
система электронного сканирования

ESST (electrical signal storage tube)

запоминающая ЭЛТ с электрическими входным и выходным сигналами

ESURF (electron-beam surface heating)
электронно-лучевой нагрев поверхности

ET (electronic tube)
электронная лампа

ETFT (enhancement-mode TFT)
тонкопленочный транзистор в режиме обогащения

ETT (electrically triggered thyristor)
электрически управляемый тиристор

EUV (edge ultra-violet)
краевое УФ излучение

EUV (extreme UV)
излучение на границе УФ и рентгеновского диапазонов /~ 20 нм/

EXELFS (extended energy loss fine structure)

протяженная тонкая структура в спектрах потерь энергии электронов

F

FAB-sputtering (fast atom bombardement (beam) sputtering)
распыление /мишени/ пучком быстрых атомов

FAIE (field assisted internal emission)
внутренняя эмиссия, усиливаемая полем

FAL (flat active layer)
плоская активная область

FAST (fixed abrasive slicing technique)
метод разрезания фиксированным абразивом

FB (flat band)
плоская зона /"напряжение плоских зон" в методе вольт-фарадных характеристик/

FB (film bolometer)
пленочный болометр

FBEM (fixed-beam transmission electron microscope)
просвечивающий электронный микроскоп с фиксированным лучом /режим, обеспечивающий высокое разрешение/

FBK (finite beam klystron)
клистрон с конечным пучком

FC (flip-chip)
метод обратного /перевернутого/ монтажа

FC (ferroelectric carrier)
сегнетоэлектрический носитель

FCA (film carrier assembly)
сборка бескорпусных ИС на ленте-носителе

FCAT (floating-gate channel corner avalanche transistor)
полевой транзистор с плавающим затвором и лавинной инжекцией через угловые участки канала

FCC (face-centered cubic)
гранецентрированная кубическая /ГЦК/ решетка

FDMS (flash desorption mass-spectrometry)
масс-спектрометрия вспышечной десорбции

FDS (flash desorption spectroscopy)
спектроскопия вспышечной десорбции

FDS (field desorption spectroscopy)
спектроскопия полевой десорбции

FDTK (floating-drift-tube klystron)
клистрон с плавающим потенциалом трубки дрейфа

FE (flash evaporation)
метод взрывного испарения

FE (field emission)
автоэлектронная эмиссия

FE (ferroelectric)
сегнетоэлектрик

FEC (field emission cathode)
автоэмиссионный катод

FED (field emission deposition)
осаждение пленок с использованием автоионного распылителя /жидкометаллического источника ионов/

FED (ferroelectric display)
сегнетоэлектрический индикатор

FEE (field electron emission)
автоэлектронная эмиссия

FEED (field emitted electron distribution)
энергетическое распределение автоэлектронов

FEEM (field-electron emission microscope)
автоэмиссионный электронный микроскоп

FEFED (ferrielectric field effect device)
сегнетоэлектрический полевой прибор

FEG (field emission gun)
электронная пушка с автоэмиссионным катодом

FEL (free electron laser)
лазер на свободных электронах /ЛСЭ/
см. также ОК

FEM (field electron microscope)
автоэмиссионный электронный микроскоп

FERP (field emission retarding potential) methode	FIB (focused ion beam) сфокусированный ионный пучок
метод задерживающего потен- циала для автоэмиссионного тока /метод измерения рабо- ты выхода/	FIJ (field induced junction) индуцированный полем пе- реход
FES (field emission spectroscopy) автоэмиссионная спектро- скопия	FIM (field ion micro- scope) автоэмиссионный ионный микроскоп
FESE (field enhanced secondary emission) см. FESEE	FIM (focused ion milling) фрезерование сфокусирован- ным ионным пучком /ионно- лучевое фрезерование/
FESEE (field enhanced secondary electron emission) усиленная полем вторично- электронная эмиссия см. также FSSEE, FESE	FIR (frustrated inter- nal reflection) нарушенное полное внутрен- нее отражение
FETDS (field emission thermal desorption spectroscopy) автоэмиссионная термодес- сорбционная спектроскопия	FL (Fermi level) уровень Ферми
FETT (field effect tetrode transistor) полевой тетрод	FLA (flash lamp annealing) импульсный отжиг /от лам- пы-вспышки/
FF (fill factor) коэффициент заполнения ВАХ /солнечных элементов/	FLAD (fluorescent ac- tivated display) индикатор с люминесцент- ной подсветкой
F ² R (fully-framed- fully recessed) изоляция полностью заглуб- ленным слоем внутри рамки	FLE (Fermi level energy) энергия Ферми
FG (floating gate) плавающий затвор /затвор с плавающим потенциалом/	FLIR (forward- looking IR) ИК-система передачи об- зора /ИК-СПО/ в перед- нюю полусферу

FLL (fine line lithography)
прецизионная литография

FLP (flat-pack package)
плоский корпус МС с горизонтальным расположением выводов

FLR (field-limiting ring)
кольцевое ограничение поля в целях повышения напряжения пробоя

FLT (fine leak tester)
высокочувствительный теческатель

FM (frequency-modulated)
частотно-модулированный

FMOS (floating-gate MOS)
МОП ПТ с плавающим затвором

F-N-curve (Fowler-Nordheim curve)
характеристика Фаулера-Нордгейма

FORR (fibre-optic ring resonator)
кольцевой волоконно-оптический резонатор

FOV (field of view)
поле зрения /обзора/

FPA (focal plane array)
матричный приемник изображения в фокальной плоскости /фокальная матрица/

FP-cavity (Fabry-Perot cavity)
оптический резонатор
Фабри-Перо

FPD (flat panel display)
плоская индикаторная панель

FPP (flat plastic package)
плоский пластиковый корпус

FRED (fast recovery epitaxial diode)
эпитаксиальный диод с быстрым восстановлением

FREDFET (fast-recovery reverse diode FET)
мощный МОП ПТ с обратносмещенным диодом с быстрым восстановлением

FRS (frequency-resolved spectroscopy)
спектроскопия с частотным разрешением

FSCL-current (fully-space-charge limited current)
ток, полностью ограниченный пространственным зарядом

FSD (flat screen display)
дисплей с плоским экраном

FSE (funnel-shaped electrode)
воронкообразный /конусный/ электрод

FSF (front-surface field)
поле, встроенное у фронтальной поверхности /солнечного элемента/

FSH (funnel-shape hole)
коническое отверстие в
апертурной маске

FSS (fast surface states)
быстрые поверхностные
состояния

FSSEE (field stimulated secondary electron emission)
см. FESEE

FSST (flying spot scanning tube)
ЭЛТ со сканированием бегущим лучом

FST (fast switching thyristor)
тиристор с быстрым переключением

FT (frame transfer imager)
твердотельный преобразователь изображения с кадровым переносом

FT (fluorescent target)
люминесцентная мишень

FTC (film-type circuit)
пленочная микросхема

FT CCD (frame transfer CCD)
ПЗС-преобразователь изображения с покадровым переносом

FTD (field-terminated diode)
диод на подложке, используемой для создания требуемой конфигурации электрического поля

FTD (fast turn-on diode)
диод с быстрым переключением

FTFET (four-terminal FET)
полевой тетрод

FTIR (Fourier-transform IR-spectroscopy)
ИК Фурье-спектроскопия

FTL (fully temperature limited)
/катод/ в режиме насыщения эмиссионного тока

FTM (film thickness monitor)
измеритель толщины пленки

FT-MS (Fourier-transform mass-spectrometry)
масс-спектрометрия с Фурье-преобразованием сигнала

FTS (Fourier transform spectroscopy)
Фурье-спектроскопия

Full-Rox (full-recessed oxide)
полностью заплубленный слой окисла

FWT (fast wave tube)
СВЧ лампа на быстрых волнах

FX (fluorescent X-ray analysis)
рентгеновский флуоресцентный анализ /РФА/

G

GATO (gate-assisted turn-off thyristor)
см. GTO

GATT (gate-assisted turn-off thyristor)
см. GTO

GAV (gallium arsenide varactor)
варактор на арсениде галлия

GB (grain boundaries)
границы зерен /в поликристаллическом материале/

GB (gate bias)
смещение затвора

GBD (grain boundary dislocation)
дислокации на границах зерен поликристаллического материала

GBP (gain-bandwidth product)
произведение усиления на ширину полосы

GB-SQW (graded barrier single quantum well)
одиночная квантовая яма с варизонным барьерным слоем

GBT (graded-base transistor)
дрейфовый транзистор с градиентом концентрации примеси в области базы

GBWO (gyro-BWO)
лампа обратной волны гиروتронного типа /гиrolов/

GC (growth of crystal)
выращивание монокристалла

GCD (gate controlled diode)
диод с управляющим затвором

GCS (gate controlled switch)
переключатель с управляющим электродом

GCS (gate controlled silicon rectifier)
кремниевый тиристор

GCSP (guide channeled-substrate planar) laser
лазерный диод с волноводной планарной структурой с каналом в подложке

GD-a-Si (glow discharge a-Si)
аморфный кремний, полученный разложением силана в тлеющем разряде

GDC (graphics display controller)
контроллер графического дисплея

GDD (gas discharge device)
газоразрядный прибор /ГРП/
см. также GT (gas tube)

GDDE (gradually-doped source-drain extension)
промежуток исток-сток, ле-

гированный с градиентом
концентрации примеси

GDL (gas discharge
laser)
газоразрядный лазер

GDI (glow discharge
indicator)
индикаторная лампа тлею-
щего разряда

GDMS (glow discharge
mass-spectrometry)
масс-спектрометрия тлею-
щего разряда

GDOS (glow discharge
optical spectroscopy)
оптическая спектроскопия
тлеющего разряда

GDT (gas-discharge
tube)
газоразрядная трубка

GDT (glow discharge
tube)
лампа тлеющего разряда
см. также GT (glow tube)

GDT (grown-diffused
transistor)
выращенный диффузионный
транзистор

GED (Gunn-effect diode)
диод Ганна

GEMFET (gain enhanced
MOS FET)
МОП ПТ с повышенным уси-
лением

GET (germanium
transistor)
германиевый транзистор

GF (gradient freeze)
направленная кристаллиза-

ция с изменением гради-
ента температуры

GFIS (gaseous field
ion source)
ионный источник с полем
вытягиванием ионов из га-
зовой среды

GFR (gas-filled
rectifier)
газотрон

GRT (gas-fielled
triode)
тиратрон

GFT (gas-filled tube)
газонаполненная лампа

GGC (global geometrical
checking)
глобальная геометрическая
проверка топологического
чертежа ИС

GGG (gadolinium-galli-
um garnet)
гадолиний-галлиевый гра-
нат

GGO MOSFET (graded gate
oxide MOSFET)
МОП ПТ с градиентом толщи-
ны подзатворного окисла
вблизи края поликремние-
вого затвора

GGPM (grid-gated photo-
multiplier)
ФЭУ с сеточным затвором

GH type LCD (guest-host
type LCD)
жидкокристаллический ин-
дикатор на эффекте "гость-
хозяин"

GI (graded index)
см. GRIN

GIF (graded index fibre)	GMSD (galvanomagnetic semiconductor device)
стекловолокно с переменным показателем преломления	гальваномангнитный полупроводниковый прибор /датчик Холла/
GIG (gadolinium iron garnet)	GO (gate oxide)
железо-гадолиниевый гранат	подзатворный окисел
GILD (gas immersion laser diffusion)	GOT (gyromonotron oscillator tube)
диффузия из газовой фазы, стимулированная лазерным излучением	гиромонотрон
GIMIS (graded energy-band-gap insulator MIS)	GPE (gas plasma etching)
МДП структура с варизонным диэлектриком	газоплазменное травление
GIP (getter-ion pump)	GR (guard ring)
getterно-ионный насос	охранное кольцо /в ЛФД/
GJ (grown junction)	GR (growth rate)
выращенный переход	скорость роста /кристалла/
GJT (germanium junction transistor)	G-R (generation-recombination)
германиевый планарный транзистор	процесс генерации-рекомбинации
GJT (grown-junction transistor)	GRAPD (guard-ring avalanche photodiode)
транзистор с выращенным переходом	лавинный фотодиод с охранным кольцом
GL (gas laser)	GRECC (graded-index-rod external-coupled cavity)
газовый лазер	внешний связанный резонатор с градиентом показателя преломления в волноводной области
GL (grid leak)	GREG (gradient recrystallization and growth)
сопротивление цепи управляющей сетки	градиентная рекристаллизация и выращивание
GM (Geiger-Müller counter)	GRIN (graded index)
счетчик Гейгера-Мюллера	постепенно изменяющийся

показатель преломления
/градиент показателя
преломления/
см. также GI

GRN (generation-recom-
bination noise)
генерационно-рекомбинаци-
онный шум

GRP (glass reinforced
plastic)
корпус из армированной
стеклом пластмассы

GRS (gamma-ray spect-
roscopy)
гамма-спектроскопия

GSMBE (gas source mo-
lecular-beam epitaxy)
молекулярно-лучевая эпи-
таксия с газообразным ис-
точником

GSO (gadolinium
ortosilicate)
ортосиликат гадолиния
/осцинтиллятор/

GSPC (gas scintillation
proportional counter)
газовый сцинтилляционный
пропорциональный счетчик

GSV (gate-source
voltage)
напряжение затвор-исток

GT (glow tube)
см. GDT

GT (gas tube)
см. GDD

GT (gas-tight)
газонепроницаемый

GICR (gate-turn-off
controlled rectifier)
см. GTO

GTO (gate turn-off
(thyristor))
запираемый тиристор с
выключением по цепи управ-
ляющего электрода
см. также GATO, GATT, GTCR

GIWT (gyro-TWT)
лампа бегущей волны гиро-
тронного типа /гиро-ЛБВ/

GUT (gate underlaid
transistor)
транзистор с затвором на
изолирующей подложке

GXR (grazing X-ray
reflection)
/метод/ отражения сколь-
зящего рентгеновского из-
лучения

Н

HCMOS (hybrid comple-
mentary MOS)
гибридная КМОП структура
/комбинация Е/D CMOS и
Е/Е CMOS/
см. также CHMOS

HAPD (heterostructure
APD)
лавинный фотодиод с гете-
роструктурой

НВ (heavy-hole band)
зона тяжелых дырок

НВ (horizontal
Bridgeman)
горизонтальный метод
Бриджмена

HBT (heterojunction bipolar transistor)
 биополярный транзистор с гетеропереходом
 HC (hollow cathode)
 полый катод
 HC (hyperconductivity)
 сверхпроводимость
 HCDST (high contrast display storage tube)
 запоминающая индикаторная ЭЛТ с высоким контрастом
 HCL (hollow cathode laser)
 лазер с полым катодом
 HCP (heterojunction-contact photoconductor)
 фоторезистор с гетеропереходом в области контакта /с простойкой из более широкозонного материала между металлическим контактом и полупроводником/
 HDCT (high density circuit technique)
 технология ИС с высокой плотностью элементов
 HE (heteroepitaxy)
 гетероэпитаксия
 HE (Hall effect)
 эффект Холла
 HE (hot electron)
 горячий электрон
 HE (high efficiency)
 высокая эффективность /высокий к.п.д./
 HEAPS (high-energy electron APS)
 спектроскопия потенциала

появления быстрых электронов
 HEIB (high energy ion beam)
 пучок ионов высокой энергии
 HEL (high-energy laser)
 мощный лазер
 HELIOS (hot-electron-layer ion source)
 ионный источник со слоем горячих электронов /на основе электронного циклотронного резонанса/
 HEM (heat exchanger method)
 метод теплообменника
 HEMOS (hot electron MOS)
 МОП структура с разогретым электроном
 HEMT (high electron mobility transistor)
 транзистор с высокой подвижностью электронов
 HEM-W (hybrid electromagnetic wave)
 гибридная электромагнитная волна
 HES (heteroepitaxial system)
 гетероэпитаксиальная система
 HET (hot electron transistor)
 транзистор на горячих электронах

HFO (high-frequency oscillations)
высокочастотные колебания

HFPA (hibrid focal-plane array)
гибридная фокальная матрица /приемник изображения/

HFPP (high-field pulsed plating)
осаждение покрытий в сильном импульсном электрическом поле

HFS (hyperfine structure)
сверхтонкая структура

HFVBiG (high-focus-voltage bipotential gun)
бипотенциальная электронная пушка с высоким фокусирующим напряжением

HF/VPE (hydrogen fluoride vapour-phase etching)
травление в парах HF

HGF (horisontal gradient freeze)
метод кристаллизации в горизонтальном градиенте температуры

HIB (heavy-ion beam)
пучок тяжелых ионов

HICAT (high-capacitance trench)
структура с разделительными канавками высокой емкости /для СВИС/

Hi-CMOS (Hitachi CMOS)
КМОП ИС фирмы Hitachi

HI/LO-resist (high-low-sensitivity resist)
система двухслойного резиста с высокой-низкой чувствительностью

Hi-Lo (high-low)
см. HI-LO

HI-LO (high-low)
переход в виде сильнолегированного слоя на слаболегированной подложке

HI-LO SAM APD (high low SAM APD)
ЛФД с разделением областей поглощения и умножения со ступенчатым уровнем легирования в области лавинного умножения

HiMOS (MNOS) (high-performance MOS (MNOS))
высококачественная МОП /МНОП/ структура
HIRBS (heavy-ion RBS)

спектроскопия обратного резерфордского рассеяния тяжелых ионов

HISSDAY (high-speed semiconductor device analysis)
экспресс-анализ полупроводниковых приборов

HIT (high density integration) technology)
технология БИС с высокой плотностью элементов

HITT (heterojunction integrated transit-time)
интегральный лавинно-пролетный гетеродиод

HJSC (heterojunction solar cell)
солнечный элемент с гетеропереходом

HL (high-low)
см. HI-LO

HL (hole-trap label)
обозначение дырочной ловушки

HLE (high-low emitter)
изотипный эмиттерный переход

HLJ (high-low junction)
изотипный переход между слоями с различной степенью легирования /n⁺ n или p⁺ p/

HM (half mirror)
полупрозрачное зеркало

HMOS (horizontal switching MOS)
ключевой МОП ПТ с горизонтальной структурой

НOMOCVD (homogeneous CVD)
однородное /равномерное/ химическое осаждение из паровой фазы

HORDIS (hot reflex discharge ion source)
сильноточный ионный источник на основе отражательного разряда с накалимым катодом

HP (high pressure)
высокое давление

HP-Ge, Si (high purity Ge, Si)
Ge, Si высокой чистоты

HPL (holographic photolithography)
голографическая фотолитография

HPT (heterojunction phototransistor)
фототранзистор с гетеропереходом

HR (high resolution)
высокое разрешение

HREELS (high-resolution electron energy loss spectroscopy)
спектроскопия потерь энергии электронов с высоким разрешением
см. также HRELS

HRELS (high resolution electron loss spectroscopy)
см. HREELS

HREM (high-resolution electron microscopy)
электронная микроскопия с высоким разрешением

HRIR (high resolution IR)
ИК-система с высоким разрешением

HRLC (high reliability low cost) IC
дешевая ИС высокой надежности /высокая надежность при низкой стоимости/

HRO (heteroepitaxial ridge-overgrown)
гетероэпитаксиальный /лазерный диод/ с реберным контактом поверх изолирующего слоя

HRT (hard-ray tube)
источник жесткого рентгеновского излучения

HRXT (high-rating
X-ray tube)

мощная рентгеновская
трубка

HSC²MOS (high-speed
clocked complementary MOS)
быстродействующая синхронизованная КМОП ИС

HSJ (half-sided
junction)
модель поверхности с обедненным слоем, рассматриваемой как половина перехода

HSP (heat-sinking
package)
корпус с теплоотводом

HSP (hermetically sealed
package)
герметизированный корпус

HSRSS (high-speed
raster-scan system)
быстродействующая растровая сканирующая система

HSS (high-speed
scanning)
высокая скорость сканирования

HSZD (hermetically
sealed Zener diode)
герметизированный стабилитрон

HT (heterostructure
transistor)
гетеротранзистор
HT-annealing (high
temperature annealing)
высокотемпературный отжиг

HTCVD (high temperature
CVD)
высокотемпературный процесс химического осаждения из паровой фазы

HVEE (high voltage
electron exposure)
высоковольтная система электронного экспонирования

HVS (high vacuum
system)
высоковакуумная система

HVSEM (high-voltage scanning
electron microscope)
высоковольтный растровый электронный микроскоп

HVT (high voltage
tube)
высоковольтная трубка

HWE (hot wall
epitaxy)
эпитаксия методом горячей стенки

HWE (hot-wall evaporation)
напыление пленок методом горячей стенки

HWF (hot-wall-flash)
метод мгновенного испарения в условиях горячей стенки
см. также HWFE

HWFT (hot-wall flash
evaporation)
см. HWF

HX (heat exchanger)
теплообменник

I

IA (image amplifier)
усилитель изображения

IA (image array)
матричный преобразователь
изображения

IAD (ion-assisted
deposition)
термическое напыление с
одновременным ионным об-
лучением
см. также IVD

IAES (ion-induced
AES)
электронная оже-спектро-
скопия с ионным возбуж-
дением

IAL (inclined active
layer)
наклонная активная об-
ласть

IAO (ion angular
distribution)
угловое распределение
ионов /при электроноста-
мулированной десорбции/

IAT (ion-accelerator
tube)
ионный ускоритель

IB (ion beam)
ионный пучок

IBAE (ion beam
assisted etching)
ионно-лучевое /безмасоч-
ное/ травление

IBB (ideal black
body)
абсолютно черное тело

J

JBS-rectifier (junction-
barrier-controlled
Schottky rectifier)
тиристор с управляющим
барьером Шоттки

JMOS (joint MOS)
ИС на n- и p-канальных
МОП ПТ с соединенными
затворами

JCMOS (CMOS-transistor
with junction gate)
КМОП ПТ с управляющим пе-
реходом

JCMOS (joint-gate
CMOS)
КМОП структура с объеди-
ненным затвором /с само-
совмещением истока и сто-
ка обоих транзисторов с
электродом объединенного
затвора/

JMA (Josephson memory
array)
матричное ЗУ на эффекте
Джозефсона

JMOS (junction-MOS)
МОП транзистор с управ-
ляющим переходом

JPT (junction photo-
transistor)
плоскостной фототранзи-
стор, биполярный фото-
транзистор/

JUFET (junction-gate
FET)
ПТ с управляющим пере-
ходом

IBC (interdigitated back contact)
встречно-штыревой тыловой контакт /солнечного элемента/

IBC (ion beam coating)
покрытие, полученное ионно-лучевым методом

IBCFA (injected beam crossed field amplifier)
усилительная электронная лампа СВЧ со скрещенными полями с инжектированным пучком

IBD (ion-beam device)
ионно-лучевой прибор

IBD (ion beam deposition)
ионно-лучевое нанесение /пленок/

IBDD (ion-beam direct deposition)
прямое ионно-лучевое нанесение

IBED (ion-beam enhanced deposition)
осаждение с ионно-лучевой стимуляцией

IBEE (ion-beam enhanced etching)
усиленное ионным облучением травление

IBESE (ion bombardment enhanced selective etching)

усиленное ионной бомбардировкой селективное травление

IBI (ion-beam implantation)
ионная имплантация

IBI (ion beam induced)
образованный под действием ионной бомбардировки

IBIE (ion-beam inhibited etching)
ослабленное ионным облучением травление

IB-MOS (ion beam MOS)
МОП структура, полученная методом ионной имплантации

IBS (ion backscattering spectroscopy)
спектроскопия обратнорассеянных ионов /ионно-рассеивательная спектроскопия/

IBS (ion beam sputtering)
ионно-лучевое распыление

IBSCA (ion beam spectro-chemical analysis)
ионно-лучевой спектроскопический анализ

IBSD (ion-beam sputter deposition)
нанесение /пленок/ методом ионно-лучевого распыления

IBSM (ion-beam scanning method)
метод ионно-лучевого сканирования

IBSM (ion-beam sputter etching or machining)
травление или формообразование методом ионно-лучевого распыления

IBT (intrinsic-barrier transistor)
транзистор с внутренним барьером

IC (image converter)
преобразователь изображения

IC (ionization chamber)
ионизационная камера

ICA (integrated circuit analyzer)
анализатор интегральных микросхем

ICB (IC breadboard)
макет ИС

ICB (ionized cluster beam)
пучок ионизированных кластеров

ICC (internal conversion coefficient)
коэффициент внутренней конверсии

ICES (internal conversion electron spectroscopy)
спектроскопия электронов внутренней конверсии

ICF (IC family)
семейство ИС

ICID (intensified charge injection device)
ПЗИ с повышенным уровнем инжекции

ICIG (integrated coherent infrared generator)
интегральный источник когерентного ИК излучения

ICISS (impact-collision ion scattering spectroscopy)
ионно-рассеивательная спектроскопия в режиме ударных столкновений

ICL (IC layout)
размещение элементов на ИС

ICP (IC package)
корпус интегральной микросхемы, интегральный модуль

ICR (ion cyclotron resonance)
ионный циклотронный резонанс

ICRH (ion cyclotron resonance heating)
разогрев /плазмы/ методом ионного циклотронного резонанса

ICRF (ion cyclotron range of frequencies)
частотный диапазон ионного циклотронного резонанса

ICT (image converter tube)
электронно-оптический преобразователь изображений /ЭОП/

ICT (IC technology)
технология ИС

IC TMP (IC tri-metal processing)
технология ИС с трехуровневой металлизацией

ICTS (IC test system)
система проверки ИС

ICTS (isothermal capacitance transient spectroscopy)
изотермическая емкостная нестационарная спектроскопия /глубоких уровней/

ICVD (ion beam CVD)
ионно-лучевое осаждение из паровой фазы

ID (image device)
преобразователь изображения

ID (interconnection diagram)
схема межсоединений /ИС/

ID (inversed diode)
обращенный диод

IDC (image dissector camera)
диссектор

IDC (impregnated dispenser cathode)
распределительный импрегнированный катод

IDCCC (integrated decoupling capacitor chip carrier)
кристаллоноситель с интегральным развязывающим конденсатором

IDU (indicator drive unit)
блок возбуждения индикатора

IE (infrared emission)
ИК излучение

IED (ion energy distribution)
энергетическое распределение ионов

IEE (ion-induced electron emission)
ионно-электронная эмиссия

IEI (integrated etalon interference) laser
эталонный лазер со встроенным интерферометром

IEMM (incidence energy modulation method)
метод модуляции падающего излучения

IES (ion-electron spectroscopy)
ионно-электронная спектроскопия

IET(S) (inelastic electron tunneling spectroscopy)
спектроскопия неупругого квантово-механического туннелирования электронов

IFA (infrared flash annealing)
импульсный ИК отжиг

I-F-T-emission (ion-field-thermoelectron emission)
ионно-электронная авто-термоэмиссия /в плазму при дуговом разряде/

IGP (ion getter pump)
ионно-сорбционный насос

IGR (insulated-gate rectifier)
тиристор с изолированным затвором

IGT (insulated-gate transistor)
ПГ с изолированным затвором

INC (indirectly heated cathode)
катод косвенного накала

IID (ion induced desorption)
десорбция, индуцированная ионной бомбардировкой

IID (ion-implanted device)
прибор, изготовленный методом ионной имплантации

IIJ (ion-implanted junction)
переход, полученный методом ионной имплантации

II-PLASA (ion-implanted planar-mesa)
меза-плана́рная технология в сочетании с ионной имплантацией

IIR (ion-impact induced radiation)
излучение, индуцированное ионной бомбардировкой

IIR (intermediate IR)
излучение в средней части ИК диапазона

IIR (ion-implanted region)
ионно-леги́рованная область

III (image intensifier tube)
усилитель яркости изображения

IIIXE (ion-induced X-ray emission)

/спектроскопия/ ионно-индуцированного рентгеновского излучения

IL (inversion layer)
инверсионный слой /с переменной типа проводимости/

IL (ion laser)
ионный лазер

IL (indicating lamp)
индикаторная лампа

IL CCD (interline transfer CCD-imager)
см. ITCCD

ILD (injection laser diode)
инжекционный лазерный диод

ILS (ionization loss spectroscopy)
спектроскопия ионизационных потерь

IM (ion milling)
ионное фрезерование

IMFP (inelastic mean free path)
средняя длина пробега для неупругих взаимодействий

IMMA (ion microprobe mass-analyser)
ионный микрозондовый масс-анализатор

I-MOS (induced inversion layer MOS)
МОП структура с индуцированным инверсионным слоем

IMOX (ion-implanted oxide-isolation process) технология ИС с использованием ионной имплантации и боковой изоляции окислом

IMP (integrated microwave package) интегральный СВЧ модуль

IMP A (ion microprobe analysis) ионный микроанализ /анализ поверхности с помощью ионного микронзонда/

IMS (ion-mobility spectroscopy) спектроскопия подвижности ионов

INMS (ionized neutral mass-spectrometry) масс-спектрометрия ионизированных атомов

INS (ion-neutralization spectroscopy) ионно-нейтрализационная спектроскопия

INWATE (integrated waveguide technology) технология интегрированных волноводов

IO (image orthicon) суперортикон

IOC (intercell ohmic contact) межэлементный омический контакт /в каскадных солнечных элементах/

IOEC (integrated optoelectronic circuit) оптоэлектронная интегральная микросхема

IOP (isolation by oxide and polysilicon) изоляция оксидом и поликремнием

IP (ion plating) ионное нанесение покрытий

IPAT (ion plating and allied techniques) ионное нанесение покрытий и связанная с ним технология

IPC (imperfection photoconductivity) примесная фотопроводимость

IPE (inverse photoemission) spectroscopy см. IPES

IPES (inverse photoemission spectroscopy) обращенная фотоэмиссионная спектроскопия /спектроскопия изохроматического тормозного УФ излучения, электрон-фотонная спектроскопия/ см. также IPE, BIS, UBIS

IPhPE (impurity photoplastic effect) примесный фотомеханический эффект

IPL (ion projection lithography) ионная проекционная литография

IPS (ion-induced photon emission spectroscopy) ионно-фотонная спектроскопия /ИФС/

IPS (ion projection system)
ионный прожектор /ионная пушка/

IQE (internal quantum efficiency)
внутренняя квантовая эффективность

IRAM (integrated RAM)
ЗУПВ в интегральном исполнении

IRCID (IR-charge injection device)
приемник ИК-изображения на ПЗИ

IRCON (IR-detector)
приемник ИК излучения /в том числе пирометр/

IREB (intense relativistic electron beam)
интенсивный релятивистский электронный пучок

IRI (internal reflection interference) laser
лазерный диод с внутренней интерференцией

IRQ (IR-quenching)
ИК-гашение какого-либо эффекта ИК облучением/

IRQC (IR quantum counter)
счетчик фотонов, чувствительный в ИК области спектра

IRRS (IR reflection spectroscopy)
спектроскопия отражения ИК излучения

IRS (inter-reflection spectroscopy)
спектроскопия /полного/ внутреннего отражения

IRT (intrinsic region transistor)
транзистор со структурой pnip

IRTA (infrared rapid thermal annealing)
быстрый ИК-термический отжиг

IRW (inverted rib waveguide)
волновод в виде обращенного ребра

IS (ion source)
ионный источник

IS (ionization spectroscopy)
ионизационная спектроскопия

ISL (inverted superlattice)

обращенная сверхрешетка /CP/ /подложка / n^+ /CP/ n^- / n^+ /

ISM (insulator-semiconductor-metal)
структура диэлектрик-полупроводник-металл /ДПМ/

ISO (isoplanar)
изопланарная структура, технология /планарная структура с изоляцией окислом/
см. также ISOPLANAR

ISOFET (isolated polysilicon oxide gate FET)
полевой транзистор с поликремниевым затвором и окисной изоляцией

ISO HCMOS (isolated silicon-oxide-gate high-density CMOS)
КМОП ИС с поликремниевыми затворами и окисной изоляцией с высокой плотностью элементов

ISOPLANAR (insulation oxide planar)
изопланарная технология см. ISO

ISOPLANAR-S (ISOPLANAR process with scaling)
изопланарная технология с уменьшением масштаба

ISOVPE (isothermal VPE)
изотермическая парофазная эпитаксия

ISPD (intensified silicon photodiode array)
кремниевая фотодиодная матрица с предусилителями

ISSA (intensified self-scanned array)
самосканирующая матрица с предварительным усилением

IT (interline transfer) CCD
ПЗС с межстрочным /или строчным-кадровым/ переносом

ITC (induced thermocurrent)
индуцированный термоток

ITC (ionic thermocurrent)
ионный термоток

ITCCD (interline transfer CCD-imager)
ПЗС-преобразователь изображения с межстрочным переносом см. также ILCCD

ITDS (isothermal desorption spectroscopy)
изотермическая десорбционная спектроскопия

ITG (integrated twin-guide) laser
лазерный диод со сдвоенным волноводом в интегральном исполнении

ITIC (isothermal transient ionic current)
/метод/ изотермического переходного ионного тока /измерение переходного тока, вызванного подвижными ионами после снятия напряжения/

ITM (implantation through metal)
имплантация через слой металла

ITO (indium-tin oxide)
 $\text{SnO}_2\text{-In}_2\text{O}_3$
окись индия-олова /прозрачный проводящий слой/

ITS (inelastic tunneling spectroscopy)
спектроскопия неупругого туннелирования

ITTD (injection transit-time diode)
инжекционно-пролетный диод

IVD (ion and vapour deposition)
см. IAD

IVPO (inside vapor-phase-oxidation)
внутреннее окисление из паровой фазы под пленкой

IXS (ion-excitation X-ray spectroscopy)
спектроскопия ионно-возбужденного рентгеновского излучения

К

KDP (kalium dihydrogen-phosphate KH_2PO_4)
дигидрофосфат калия /КДП/

KLA (klystron amplifier)
клистронный усилитель

KLO (klystron oscillator)
клистронный генератор

KRIPES (k-resolved inverse photoemission spectroscopy)
обращенная фотоэмиссионная спектроскопия с разрешением по тангенциальному моменту K_{\parallel} /зависимость интенсивности монохроматического УФ излучения от угла падения электронного пучка/

L

LA (laser annealing)
лазерный отжиг

LAMMA (laser microprobe mass-analysis)
масс-анализ с лазерным микрозондом

LAS (laser-assisted soldering)
лазерная пайка

LASS (laser-activated semiconductor switch)
полупроводниковый переключатель, управляемый лазером

LATS (luminescence-assisted two-photon spectroscopy)
двухфотонная люминесцентная спектроскопия

LAXS (low angle X-ray scattering)
малоугловое рассеяние рентгеновского излучения

LAZ (laser alloyed zone)
область лазерного легирования

LB (Langmuir-Blodgett)
пленка Лэнгмюра-Блоджетт /пленка органического вещества мономолекулярной толщины/

LBIC (laser-beam induced current)
ток, наведенный лазерным облучением

LBIC (light-beam induced current)
ток, наведенный световым лучем

LB MOS (lateral-merged bipolar MOS)
объединенные по горизон-

тали биполярный транзистор
и МОП ПТ

LBP (laser-beam printer)
лазерное записывающее устройство

LBT (lambda bipolar transistor)
лямбда-биполярный транзистор со специальным профилем концентрации в эмиттерной области

LCAO (linear combination of atom orbitals)
теория /приближение/ линейной комбинации атомных орбиталей /ЛКАО/

LCCC (leadless ceramic chip carrier)
безвыводная керамическая подложка

LCCD (liquid crystal character display)
символьный жидкокристаллический индикатор

LCDD (LCD-driver)
схема возбуждения жидкокристаллического индикатора

LCGD (liquid crystal graphic display)
графический дисплей на жидких кристаллах

LCLV (liquid crystal light valve)
жидкокристаллический световой клапан

LC MOS (long channel MOS)
МОП ПТ с длинным каналом

LCMOS (low-threshold CMOS)
низкопороговый КМОП транзистор

LCRT (laser cathode ray tube)
электронно-лучевая трубка с экраном в виде матрицы полупроводниковых лазеров

LCSW (light-coupled semiconductor switch)
полупроводниковый переключатель с оптической связью

LCVD (laser-assisted induced CVD)
химическое осаждение из паровой фазы с лазерной стимуляцией

LD (laser diode)
лазерный диод

LD (leak detector)
вакуумный течеискатель

LD²MOS (lateral double-diffused MOS)
планарная МОП структура, полученная двойной продольной диффузией

LDMS (laser desorption mass-spectrometry)
масс-спектрометрия продуктов стимулированной лазерным облучением десорбции

LDOS (local density of states)
локальная плотность состояний
см. также LDS

LDS (local density of states)
см. LDOS

LEAPS (low-energy electron APS)
спектроскопия потенциалов появления медленных /вторичных/ электронов

LEC (liquid encapsulation Czochralski)
метод Чохральского с жидкостной герметизацией

LEEOA (LEED optical analyzer)
оптический анализатор электронографа

LEEIXS (low-energy electron induced X-ray spectroscopy)
спектроскопия рентгеновского излучения, индуцированного бомбардировкой медленными электронами

LEELS (low-energy electron loss spectroscopy)
спектроскопия потерь энергии медленных электронов
см. также LELS

LEER (low-energy electron reflection)
/спектроскопия/ медленных отраженных электронов

LEES (low-energy electron spectroscopy)
электронная спектроскопия в области низких энергий электронов

LEF (light-emitting film)
пленочный излучатель

LEF-laser (lateral evanescent field laser)

лазерный диод с продольным затухающим полем /с поперечным ограничением/

LEGO (lateral epitaxial growth over oxide)
эпитаксиальное разращивание над окислом

LEIT (light emission via inelastic tunneling)
оптическое излучение, возбужденное неупругим туннелированием /в МДП структурах/

LEK (liquid encapsulation Kyropoulos)
метод Киропулоса с жидкостной герметизацией

LELS (low electron loss spectroscopy)
см. LEELS

LEMS (low-energy molecular-beam sputtering)
распыление пучком медленных молекул

LENS (low-energy neutral scattering)
/спектроскопия/ рассеяния медленных нейтральных атомов

LEO (lateral epitaxial overgrowth)
эпитаксиальное разращивание над слоем диэлектрика

LEO (linear electro-optic)
линейный электро-оптический

кий эффект /эффект По-
кельса/

LEPD (low-energy po-
sitrion diffraction)
дифракция медленных позит-
ронов

LESEM (low-energy scann-
ing electron microscop)

растровый электронный мик-
роскоп в режиме низких
энергий /медленных элект-
ронов/

LESER (ligh-induced
ESR)
оптически-индуцированный
ЭПР

LESS (local epitaxial
seeding of silicon)
локальное эпитаксиальное
осаждение кремния

LETJ (light emitting
tunnel junction)
светоизлучающий туннельный
переход

LFO (low-frequency
oscillations)
низкочастотные колебания

L-G (liquid-gas)
система /фазовый переход/
жидкость-газ

LGR-laser (localized-
gain region laser)
лазерный диод с локализо-
ванной /ограниченной/ об-
ластью усиления

LN (low/high)
изотипный переход с низ-
кой/высокой степенью ле-
гирования

LIB (light-ion beam)
пучок легких ионов

LID (laser-induced
damage)
повреждения, индуцирован-
ные лазерным облучением

LID (laser-induced
desorption)
десорбция, индуцированная
лазерным облучением

LIGR (lateral insulated
gate rectifier)
тиристор с боковым изоли-
рованным затвором

LIMA (laser-induced
ion mass-analysis)
масс-анализ ионов, эмити-
рованных под действием
лазерного излучения

LIMP (laser-induced me-
dium perturbation)
возмущение среды, индуци-
рованное лазерным облуче-
нием

LINAC (linear accele-
rator)
линейный ускоритель

Lin CMOS (linear CMOS)
КМОП структура с линейно-
совмещенными кремниевыми
затворами

LL, L^2 (long life).
долговечный /с большим
сроком службы/

LLL (low light level)
низкий уровень освещенно-
сти

LLT (lifted lead
transistor)
транзистор с приподнятыми
выводами

LM (light modulator)
оптический модулятор

LMI(S) (liquid-metal
ion source)
жидкометаллический источник ионов

LMR (low molecular-
weight resist)
органический резист из материала с низким молекулярным весом

LMS (laser mass-
spectrometry)
лазерная масс-спектрометрия /ЛМС/

LN (low noise)
малошумящий

LN (liquid nitrogen)
жидкий азот

LN₂ (liquid nitrogen)
см. LN

LO (longitudinal
optical)
продольный оптический /фонон/

LOC (large optical
cavity)
большой оптический резонатор

LO-DMOS (double-diffused MOS structure,
using LOCOS technology)
МОП транзистор, полученный методом двойной диффузии с применением локального окисления кремния

LOES (laser optical
emission spectroscopy)
лазерная эмиссионная спектроскопия

LO/HI (low-sensitive
resist on high-sensitive resist)
система двуслойного резиста - низкочувствительный на высокочувствительном

LO/HI/LO (low-high-low)
система трехслойного резиста с низкой/высокой/низкой чувствительностью

LOM (lift-off method)
метод взрывной литографии /отслаивания/
см. также LT (lift-off technique)

LOPAC (low-power-dissipation bipolar IC)
биполярная ИС с малой мощностью рассеяния

LP (low pressure)
низкое давление

LPCC (lead plastic chip carrier)
пластмассовый кристаллоноситель с выводами

LP-MOCVD (low-pressure metalorganic chemical vapour deposition)
химическое осаждение из паровой фазы металлоорганики при низком давлении

LP MO VPE (low pressure MO VPE)
парофазная эпитаксия в парах металлоорганики низкого давления

LPMS (laser-probe
mass-spectrometry)
масс-спектрометрия с ла-
зерным зондом

LPP (laser produced
plasma)
лазерная плазма

LPPD (low pressure
plasma deposition)
плазменное осаждение при
низком давлении

LPSEI (low pressure selec-
tive epitaxial isolation)
изоляция методом селек-
тивной эпитаксии при
низком давлении

LPVE (lateral photovol-
taic effect)
продольный фотогальвани-
ческий эффект

LQ-a-Si (liquid-quenched
a-Si)
аморфный Si, полученный
закалкой расплава

LR (laser recrystalli-
zation)
лазерная рекристаллизация

LRF (laser resonance
fluorescence)
лазерная резонансная флу-
оресценция

LRO (long-range
order)
дальний порядок /атомная
корреляция на больших рас-
стояниях/

LRS (laser Raman
spectroscopy)
лазерная спектроскопия
комбинационного рассеяния

LS (logic scheme)
логическая схема

LSA (laser surface
alloying)
поверхностное лазерное
легирование

LSA (laser scanning
array)
матрица, сканируемая ла-
зерным лучом

LSA (light-switching
array)
светоклапанная панель

LSC (luminescent solar
concentrator)
люминесцентный концент-
ратор солнечного излуче-
ния

LSDI (large-scale dis-
play integration)
технология индикаторов с
высокой степенью интег-
рации

LSIC (low-speed IC)
ИС на частотный диапазон
0,1 МГц

LSI/DRA (LSI/discretio-
nary routed array)
ВИС с избирательными сое-
динениями

LSM (laser surface
melting)
поверхностное плавление
с помощью лазерного об-
лучения

LSPE (lateral solid
phase epitaxy)
боковая твердофазная эпи-
таксия /разрачивание в
сторону/

LSR (lift-off using selective reaction)
снятие слоя методом селективных реакций

LSR (load shifting register)
сдвиговый регистр загрузки

LSR (large storage ring)
большое накопительное кольцо

LSSL (lateral surface superlattice)
продольная поверхностная сверхрешетка

LT (lateral transistor)
горизонтальный /продольный/ транзистор

LT (lift-off technique)
см. LOM

LTA (low-temperature annealing)
низкотемпературный отжиг

LT CVD (low temperature CVD)
низкотемпературное химическое осаждение из паровой фазы

LTE (local thermodynamic equilibrium)
локальное термодинамическое равновесие

LTQSIT(hy) (light triggered and light quenched static induction thyristor)
оптически отпираемый и оптически запираемый тири-

стор со статической индукцией

LTT (light triggered thyristor)
фототиристор

LVA (low-voltage avalanche)
лавинный пробой при низком напряжении

LVE (vapour levitation epitaxy)
парофазная левитационная эпитаксия /подложка "плавает", поддерживаемая давлением газа-носителя, что обеспечивает высокую равномерность осаждения/

LVM (localized vibrational mode)
локализованная колебательная мода /в спектроскопии ИК излучения/

LVSEM (low voltage scanning electron microscope)
низковольтный растровый электронный микроскоп

LVT(S) (low-voltage triode sputtering)
низковольтная триодная распылительная система

LWD (laser welder/driller)
лазерная сварка/сверление

LWIR (long-wave infrared) imagery
приборы видения в длинноволновой ИК области спектра /8-12 мкм/

LWL (linewidth control)
фиксация размера /обеспечение точного воспроизведения ширины линий в технологии ИС/

LW-PD (long wavelength photodiode)
фотодиод, чувствительный в длинноволновой ИК области спектра

LWT (lightwave technology)
технология оптической обработки

М

MAGFET (modulation-doped arsenide-gallium FET)

модуляционно-легированный GaAs ПТ /со слоем AlGaAs между GaAs и n-GaAs)

MAMA (multi-anode microchannel array)
многоанодная микроканальная матрица

MANOS (metal-alumina-nitride-oxide-semiconductor)
структура металл - окись алюминия - нитрид кремния - двуокись кремния - полупроводник /МАНОП/

MASFET (metal-alumina-semiconductor FET)
ПТ с МАП структурой

MBC (miniature beryllia circuit)

СВЧ-ИС на основе BeO-керамики

MBI (multiple-beam interferometry)
многолучевая интерферометрия

MBM (metal-barrier-metal)
структура металл-барьерный слой-металл /МБМ/

MBMS (modulated-beam mass-spectrometer)
масс-спектрометр с модуляцией пучка

MBP (modulated barrier photodiode)
фотодиод с модулированным /по высоте/ барьером

MC (metal-capillary)
металлопористый /катод/

MC (metallized ceramics)
металлизируемая керамика

MC (multilayer ceramics)
многослойная керамика /керамический модуль/

M-C (Monte-Carlo method)

расчет методом Монте-Карло

MCB (merged CMOS/bipolar)
технология совмещенных структур КМОП/биполярный транзистор

MCDL (minority carrier diffusion length)
диффузионная длина неосновных носителей

MCF (microcleaved facets)
микросколотые грани

MCM (multi-chip module)
многокристальный модуль

MCP (microchannel plate)
микроканальная пластина /МКП/

MCPM (microchannel photomultiplier)
микроканальный фотоумножитель /ФЭУ с МКП/

MCRW (metal-clad ridge-waveguide)
металлизированный реберный волновод

MCRW-laser (multicavity ridged waveguide laser)
многорезонаторный лазерный диод с реберным волноводом

MCSP (modified channelled-substrate planar)
модифицированный планарный /лазерный диод/ с каналом в подложке

MCT (mercury-cadmium telluride)
теллурид кадмия-ртути см. также СНТ

MCT (MOS-controlled thyristor)
мощный тиристор, управляемый с помощью МОП ИС

MCVD (modified chemical vapor deposition)
модифицированное химическое осаждение /кварца/ из паровой фазы

MD (misfit dislocation)

дислокация несоответствия /решеток/

MD (modulation-doped) heterostructure
модуляционно-легированная гетероструктура

MDA (magnetic deflection analyzer)
энергоанализатор с магнитным отклонением

MDM (metal-dielectric-metal)
структура металл-диэлектрик-металл /МДМ/

ME (magnetoelectret)
магнетоэлектрет

ME (meander electrode)
меандровый электрод

MEBES (manufacturing electron-beam exposure system)
технологическая установка для электронно-лучевой обработки

MEED (medium energy electron diffraction)
дифракция электронов средних энергий

MEG (multipactor
electron gun)
мультипакторная электрон-
ная пушка

MEIS (medium-energy
ion scattering)
/спектроскопия/ рассеяния
ионов средних энергий

MEIS LD (melt-etched
inner stripe laser diode)
лазерный диод с вытравлен-
ной проплавкой внутренней
полосковой структурой

MEM (mirror electron
microscope)
зеркальный электронный
микроскоп
см. также EMM

MEMISTOR (memory
resistor)
запоминающий резистор

MEPC (multielement
proportional counter)
многоэлементный пропорцио-
нальный счетчик

MESD (multielectrode
silicon detector)
многоэлектродная матрица
кремниевых детекторов
радиации

MFP (mean free path)
средняя длина пробега

MFS FET (metal-ferroelectric-
semiconductor FET)
ПТ со структурой затвора
металл-сегнетоэлектрик-
полупроводник

MGS (multilayer glass-
ceramic)
многослойная стеклокера-
мическая /подложка/

MGOS (metal-graded
oxide-semiconductor)
МОП структура с постепен-
но наращиваемым /различны-
ми методами/ слоем окисла

MGS (monolithic
GaAs/Si)
монокристаллическая интеграция
GaAs/Si структур

MHS-PD (minority-hole
sunked photodetector)
/быстродействующий/ фото-
резистор с дополнительным
затвором для вывода /мед-
ленных/ дырок /неоснов-
ных носителей/

MI (monolithic integ-
ration)
монокристаллическая интеграция

MIBE (molecular and ion
beam epitaxy)
молекулярно-ионно-лучевая
эпитаксия

MIBL (masked ion-beam
lithography)
ионно-лучевая литография
с использованием масок

MID (magnetically-insu-
lated diode)
диод с магнитной изоляци-
ей

MII (maskless ion
implantation)
безмасочное ионное леги-
рование

MINP (metal-insulator-
np-junction)
структура металл-диэлект-
рик-р-р переход

MIR (mid-infrared)
излучение среднего ИК диа-
пазона /3-5 мкм/
см. также MWIR

MIS (metal ion source)
металлический ионный ис-
точник

MISIM (metal-insulator-
semiconductor-insulator-
metal)
МДПДМ структура

MISM (metal-insulator-
semiconductor-metal)
структура металл-диэлект-
рик-полупроводник-металл
/МДПМ/

MISS (metal-thin insu-
lator-nSi-p+Si)
структура металл-тонкий
слой диэлектрика -np+ по-
лупроводниковый переход

MISS-FET (metal-thin
insulator-np + semicon-
ductor FET)
полевой транзистор со
структурой металл-тонкий
слой диэлектрика-полупро-
водниковый np+ переход

MIST (MIS thyristor)
МДП тиристор

MITATT (mixed tunneling-
avalanche transit-
time)
пролетный диод со смешан-
ной туннельной и лавинной
инжекцией

ML (monolayer)
монослой /моноатомный, мо-
номолекулярный/

MLEC (magnetic-field-
applied LEC)
метод Чохральского с жид-
костной герметизацией с
приложением магнитного
поля

MLI (multilayer in-
sulation)
многослойная изоляция

MMM (mixed-metal-
matrix)
металлопористый /катод/
на основе матрицы из сме-
си металлов

MNOSFET (metal-nitride-
oxide-semiconductor
FET)
полевой транзистор с МНОП
структурой

МО (metallo-organics)
металлоорганические со-
единения /МОС/
см. также ОМ

МО (molecular
orbital)
молекулярная орбиталь

МО (monochip)
гибридная ИС /ГИС/, со-
стоящая из отдельных
кристаллов

MOD (magneto-optic
device)
магнито-оптический прибор

MODFET (modulation-
doped FET)
модуляционно-легированный
ПТ

МОКЕ (magneto optic Kerr
effect)
магнито-оптический эффект
Керра

MO-MBE (combines MOCVD and MBE)
комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений
см. также CBE

MONOS (metal-oxide-nitride-oxide-semiconductor)
МОНОП структура

MOPS (metal-oxide-passivated silicon)
кремний, пассивированный окислом металла

MOSFIC (MOS film IC)
пленочная МОП ИС

MO-VPE (metal-organic vapour-phase epitaxy)

парофазная эпитаксия из металлоорганических соединений
см. также OM-VPE

MPA (multi-photon absorption)
многофотонное поглощение

MPE (microwave plasma etching)
травление в СВЧ плазме

MPE (multiphonon emission)
многофононная эмиссия

MPL (molecular-pattern lithography)
молекулярная литография

MPOS (metal-phosphor-silicate glass-oxide-semiconductor)

структура металл-фосфорно-силикатное стекло-окисел-полупроводник

MPPE (multi-photon photoemission)
многофотонная фотоэмиссия

MPX (multiplexing)

мультиплексирование
см. MUX

MQAS (mean quadratic angular spread)
среднее квадратичное значение углового расхождения /электронного луча/

MQW (multiple quantum-well)

многослойная структура с квантово-размерным эффектом /периодическая структура квантовых ям/

MQWH (multiple quantum-well heterostructure)

многослойная гетероструктура с квантовыми ямами /с квантово-размерным эффектом/

MRIS (multiple-reflection IR-spectroscopy)

ИК спектроскопия многократного отражения

MRT (minimum resolvable temperature)	MSMPR (mixed suspension, mixed product removal)
минимальная разрешающая разность температур /тепловизора/	непрерывный кристаллизатор с удалением смешанного продукта
MS (mass-spectrometry) масс-спектрометрия	MSSW (magnetostatic surface wave)
MS (mushroom stripe) полосковая структура грибовидного профиля	магнитостатическая поверхностная волна
MSA (multiwall self-alignment) многоступенчатое самосовмещение	MST (monolithic system technology) технология монолитных ИС
MSBVW (magnetostatic-backward volume wave) обратная объемная магнитостатическая волна	MSW (magnetostatic wave) магнитостатическая волна
MSC (multistep avalanche chamber) многоступенчатая лавинная ионизационная камера	MTBF (mean time between failures) средняя наработка на отказ /среднее время между отказами/ см. также MTTF
MSE (minimum-size effects) эффекты, связанные с предельным уменьшением размеров	MTDH (multiple twisted double heterostructure) многократно закрученная двойная гетероструктура
MSGCC (monolithic shallow-groove coupled-cavity) laser монолитная лазерная структура с приповерхностными связанными резонаторами	MTF (modulation transfer function) частотно-контрастная характеристика /ЧКХ/ см. также CMF
MSLM (microchannel spatial light modulator) микроканальный пространственный модулятор света	MTG (milky tin-oxide on glass) белая окись олова на стекле
	MTOS (metal-tantalum oxide-silicon dioxide-silicon)

структура металл-окись
тантала-двуокись крем-
ния-кремний

MTS (multitarget
sputtering)

катодное распыление с ис-
пользованием нескольких
мишеней

MTTF (mean time to
failure)

см. MTBF

MUSA/MOST (multiple
self-alignment MOS
technology)

МОП технология с много-
кратным самосовмещением

MUX (multiplexing)

мультиплексирование

см. также MPX

MVL (metal vapour
laser)

лазер на парах металла

MVM (metal-vacuum-
metal)

переход металл-вакуум-
металл

MWIR (mid-wavelength
IR)

см. MIR

MW-PD (mid-wavelength
photodiode)

фотодиод, чувстви-
тельный в средней ИК области
спектра

N

NAA (neutron activa-
tion analysis)

нейтронный-активационный
анализ

NAC (nematic-A-C-
smectic)

точка перехода нематичес-
кой фазы в смектическую
А- и С-фазу /жидкокристал-
лической смеси/

NAM (nonabsorbing
mirror)

непоглощающее зеркало

NAMIS (nitrid-barrier
avalanche injection
MIS)

МДП структура с лавинной
инжекцией с барьером из
нитрида кремния

NASICON (Na-superionic
conductor)

($\text{Na}_3\text{Zr}_2\text{PSi}_2\text{O}_{12}$)

сверхионный проводник с
подвижными ионами натрия

NBE (near-band-edge)

краевое /излучение/

NDC (nondestructive
control)

неразрушающий контроль
см. также NDT

NDR (negative differen-
tial resistance)

отрицательное дифферен-
циальное сопротивление

NDT (nondestructive
testing)

см. NDC

NEA (negative electron
affinity)

отрицательное электрон-
ное сродство /ОЭС/

NEMAG (negative effec-
tive mass amplifier
and generator)

полупроводниковый мазер

на циклотронном резонансе тяжелых дырок с отрицательной эффективной массой

NEQ (noise equivalent number of quanta)

эквивалентное шуму число фотонов

NE Δ T (noise equivalent temperature difference)
см. NETD

NETD (noise equivalent temperature difference)

эквивалентная шуму разность температур /тепловых приемников/
см. также NE Δ T

NEXAFS (near-edge X-ray absorption fine structure)

тонкая структура спектров краевого рентгеновского поглощения

NGS (narrow-gap semiconductor)
узкозонный /узкощелевой/ полупроводник

NID (nonintentionally doped)
непреднамеренно-легированный

NIM (normal-incidence monochromator)
монохроматор с падением излучения по нормали

NIR (near IR)
ближнее ИК излучение

NO (nitridized oxide)
нитрированный с поверхности окисел

NON (surface-interface nitridized oxide)
окисел, нитрированный с поверхности и по границе с подложкой /нитрид-окисел-нитрид/

NORA (nonoverlapping redundant array)
/фотоприемная/ матрица с избыточным количеством неперекрывающихся элементов

NR (negative resist)
негативный резист

NSA (nitride self-alignment)
технология самосовмещения с изоляцией нитридом кремния

NSL (normal superlattice)
нормальная сверхрешетка
/CP/ /подложка
/n⁺/n⁻/CH/n⁺)

NTD (neutron transmutation doping)
легирование методом нейтронной трансмутации

NUDJFET (nonuniformly doped junction FET)
ПТ с неоднородно-легированным управляющим переходом

NUV (near ultraviolet)
ближнее УФ излучение

NWE (narrow width effect)
эффект близости

n-well CMOS
КМОП структура с n-каналом

О

OA (optoacoustics)
оптоакустика

OB (optical bistability)
оптическая бистабильность

OCTIGUN (octupole ion gun)
ионная пушка с октупольной фокусирующей системой

OC translaser (optically coupled transistor laser)
оптически связанные полевой транзистор и лазер на общей подложке /бистабильный переключатель/

OCV (open-circuit voltage)
напряжение холостого хода

OD (order-disorder)
/фазовый переход/ порядок-беспорядок

ODE (orientation-dependent etching)
ориентационное травление

ODMR (optically-detected magnetic resonance)

оптически детектируемый магнитный резонанс /ОДМР/

OED (oxidation enhanced diffusion)
ускоренная окислением диффузия

OEMI (open end Michelson interferometric)
резонатор в виде открытого интерферометра Майкельсона

OES (optical emission spectroscopy)
оптическая эмиссионная спектроскопия

OF (optical fiber)
оптическое волокно

OFCL (optical fibre communication line)
волоконно-оптическая линия связи

OG (optical guide)
световод

OGE (optogalvanic effect)
оптогальванический эффект /изменение напряжения горения тлеющего разряда под действием лазерного облучения плазмы/

OGST (opposed gate-source transistor)
полевой транзистор с вертикальной геометрией, с истоком и затвором Шоттки на противоположных поверхностях

OISF (oxidation-induced stacking-faults)
дефекты упаковки, индуцированные окислением см. также OSF

OK (optical klystron)
оптический клистрон /лазер на свободных электронах/ см. также FEL

OLD (optoacoustic laser-beam deflection)
оптоакустическое отклонение лазерного луча

OM (organometallic) металлоорганическое соеди- нение /МОС/ см. также MO	ORD (oxidation retard- ed diffusion) замедленная окислением диффузия
OM (optical micro- scopy) оптическая микроскопия	OSF (oxidation-induced stacking faults) см. OISF
OM CVD (organometallic CVD) химическое осаждение из паровой фазы металлоорга- нических соединений	OSL (optically-stimu- lated luminescence) фотостимулированная лю- минесценция
OMO (oxidized metal overlay) покрытие из окисла металла	OSP (opto-electronic signal processor) оптоэлектронный преобра- зователь сигнала
OM VPE (organometallic VPE) парофазная эпитаксия из металлоорганических сое- динений см. также MOVPE	OTCS (optical-induced transient-current spectroscopy) релаксационная спектро- скопия фотоиндуцированно- го тока см. также PICTS
ONO (oxide-nitride- oxide) трехслойный подзатворный диэлектрик окисел-нитрид- окисел	OVD (outside vapour deposition) наружное парофазное осаж- дение /в технологии оп- тического волокна/
OPFET (optical FET) полевой фототранзистор	Р
OPO (optical paramet- ric oscillator) параметрический генера- тор оптического излучения	
OPOS (oxygen-doped polysilicon) легированный кислородом поликремний	
OPS (oxidized porous silicon) окисленный пористый крем- ний	PA (photoinduced absorption) фотоиндуцированное опти- ческое поглощение
	PACE (producible alter- native to CdTe for epitaxy) подложка, заменяющая объ- емный CdTe для эпитаксии HgCdTe /сапфир с эпитак- сиальным слоем CdTe /

PACVD (plasma-assisted CVD)	ванного ксенона /метод определения поверхностной топологии работы выхода неоднородных поверхностей/
см. PCVD	
PADESР (photoinduced absorption-detected electron spin resonance)	PВ (photon beam)
ЭПР, регистрируемый по фотоиндуцированному поглощению	поток фотонов
PAE (photoacoustic effect)	PBC (periodic bond chain)
фотоакустический эффект	периодическая цепь связей /в кристалле/
PAM (photoacoustic microscopy)	PBC-laser (p-substrate buried crescent laser)
фотоакустическая микроскопия	
PAPVD (plasma-assisted physical vapor deposition)	лазерный диод со скрытой серповидной InGaAsP активной областью на pInP подложке
физическое осаждение из паровой фазы в плазме	PВН (planar buried heterostructure)
PARPES (polarization-dependent angle-resolved photoemission spectroscopy)	планарная скрытая гетероструктура
поляризационно-чувствительная фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	PBN (pyrolytic boron nitride)
PARUPS (polarization-dependent angle resolved ultraviolet photoemission spectroscopy)	пиролитический нитрид бора
поляризационно-чувствительная УФ фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением	PC (photocathode)
PAX (photoemission of adsorbed xenon)	фотокатод
фотоэмиссия с адсорбиро-	PC (photoconductive)
	фотопроводящий
	PCD (photoconductive detector)
	фоторезистор
	PCD (photoconductivity decay)
	метод определения времени жизни носителей заряда по спаду фотопроводимости
	PCD (photon counting detector)
	счетчик фотонов

PCD (plasma-coupled device)	PD (photodetector)
прибор с плазменной связью /сдвиговый регистр с близко расположенными элементами с отрицательным сопротивлением/	фотоприемник
p-ch MOSFET (pinch-through MOSFET)	PD (photodiode)
МОП ПТ со смыканием областей пространственного заряда /с проколом/	фотодиод
PCM (portable conformal mask)	PDA (photodiode array)
съемный конформный /гибкий/ шаблон	фотодиодная матрица
PCM (photochemical machining)	PDB(T) (planar depletion-base) transistor
фотохимическая обработка	планарный транзистор с обедненной базой
PCM (phase-conjugate mirror)	PDB(T) (planar-doped barrier) transistor
фазово-сопряженный отражатель	транзистор с планарным легированным барьером /треугольной формы/
PCPS (photoconductive power switch)	PDC CAD (process-device-circuit computer-aided design)
мощный переключатель на фоторезисторах	машинное проектирование полного цикла технология-прибор-схема
PCR (phase-conjugate resonator)	PDP (plasma-developable photoresist)
фазово-сопряженный резонатор	фоторезист с плазменным проявлением
PCS (photoconductive spectroscopy)	PDP (plasma deposition process)
спектроскопия фотопроводимости	процесс плазменного осаждения
PCVD (plasma chemical vapour deposition)	PDT (photo-Darlington transistor)
плазмохимическое осаждение из паровой фазы см. также PACVD	фототранзистор в схеме Дарлингтона /фотодарлингтон/
	PDT (proportional drift tube)
	пропорциональная дрейфовая камера

PE (plasma etching)
плазменное травление

PE (polyethylene)
полиэтилен

PEA (positive electron
affinity)
положительное электронное
сродство

PEC (photoelectroche-
mical cell)
фотоэлектрохимическая
ячейка

PEC (photoelectroche-
mical etching)
фотоэлектрохимическое
травление

PED (plastic encapsu-
lated device)
прибор в пластмассовом
корпусе

PED (proton-excited
diffusion)
диффузия под действием
протонного облучения

PED (parabolic energy
distribution)
энергетическое распределе-
ние по параболическому
закону

PEEE (photo-exoelectron
emission)
см. PSEE

PEEM (photoemission
electron microscope)
фотоэмиссионный электрон-
ный микроскоп

PEFS (photoemission
extended fine structure)
тонкая структура запоро-

гового спектра фото-
эмиссии

PEL (powder electro-
luminescent)
электролюминесцентный из-
лучатель с порошковым лю-
минофором

PEM (photoelectron
multiplier)
фотоэлектронный умножитель
/ФЭУ/

PEM (photoelectro-
magnetic)
фотомагнитоэлектрический
эффект /ФМЭ/

PEME (photo-electro-
motive force)
фото-э.д.с.

PE-MOCVD (plasma-
enhanced MOCVD)
плазмо-химическое осажде-
ние из паровой фазы ме-
таллоорганических соеди-
нений

PEOS (plasma erosion
opening switch)
плазменный эрозионный
размыкатель

PES (photoemission
spectroscopy)
фотоэлектронная спектро-
скопия

PESC (passivated-
emitter solar cell)
солнечный элемент с пас-
сивированной поверхностью
эмиттера

PESC (photoelectro-
chemical solar cell)
фотоэлектрохимический
солнечный элемент

PESIS (photoelectron spectroscopy of inner shell)
фотоэлектронная спектроскопия внутренних оболочек /атомов/
PESM (photoelectron spectro-microscopy)
фотоэлектронная спектроскопия
PEV (pyroelectric vidicon)
пирозлектрический видикон /пировидикон/
PEYS (photoelectron yeld spectroscopy)
спектроскопия квантового выхода фотоэмиссии
P-F (Poole-Frenkel) /эффект/ Пула-Френкеля
PFES (photo-field emission spectroscopy)
автофотоэмиссионная спектроскопия
PFET (power FET)
мощный полевой транзистор
PG (pyrolitic graphite)
пиролитический графит
PGA (pyroelectric gas analyzer)
пирозлектрический газоанализатор
PGE (photogalvanic effect)
фотогальванический эффект
PGM (plane grating monochromator)
монохроматор с плоской дифракционной решеткой

PHD (pulse-height distribution)
амплитудное распределение
photo-CVD (photochemical vapour deposition)
фотохимическое осаждение из паровой фазы
photo-VPE
фотохимически активируемая парофазная эпитаксия
PhPE (photoplastic effect)
см. PPE
PIC (power IC)
мощная ИС
PIC-LED (picture LED)
светодиодная панель
PICTS (photoinduced current transient spectroscopy)
релаксационная спектроскопия фотоиндуцированного тока
см. также OTCS
PICVD (plasma-induced CVD)
плазмохимическое осаждение из паровой фазы
PID (pulse implantation doping)
импульсное ионное легирование
PIE (plasma-induced emission/spectroscopy)
спектроскопия индуцированного плазмой излучения
PIES (Penning ionization electron spectroscopy)

PIFET (piezoelectric-film FET)
полевой транзистор на пьезоэлектрической пленке

PIGatron (Penning-ionization gauge)
ионизационный манометр типа Пеннинга /магнитно-разрядный манометр/

PIGE (particle-induced gamma-ray emission)

тормозное гамма-излучение

PI-MBE (partially-ionized molecular-beam epitaxy)
молекулярно-лучевая эпитаксия с частичной ионизацией пучка

PINFET (pin-gate FET)
полевой транзистор с pin-затвором

PINFET (pin-diode - FET)
модуль, состоящий из pin-диода и полевого транзистора

PIN-FET (monolithically integrated pin-PD - FET-preamplifier)
фотоприемник в виде монолитно интегрированных pin фотодиода и предусилителя на ПТ

PIRLS (photo-induced Ralaigh light scattering)
фотостимулированное рэлеевское рассеяние излучения

PIXE (particle-induced X-ray emission)
рентгеновское излучение, индуцированное заряженными частицами /протонами/

PJGFET (p-channel junction-gate FET)
р-канальный ПТ с управляющим рп переходом

PL (photolithography)
фотолитография

PL (photoluminescence)
фотолюминесценция

PL (pulsed laser)
импульсный лазер

PLASA (planar-mesa)
меза-планарная /технология/

PLATMOS (platinum-diffused MOS)
МОП структура, полученная с помощью диффузии платины

PLCC (plastic leadless chip carrier)
безвыводный пластиковый корпус

PLEED (polarized low-energy electron diffraction)
дифракция медленных поляризованных электронов

PLID (pulsed-laser-induced desorption)
десорбция, индуцированная импульсным лазерным облучением

PLOSS (photoconductive layer on solid scanner) преобразующий фотопроводящий слой на твердотельном сканирующем устройстве

PLPDL (pulsed laser pumped dye laser) лазер на красителях с импульсной лазерной накачкой

PLZT (PbLaZrTi) цирконат-титанат лантана-свинца /ЦТЛС/ /пьезокерамика/

PMD (planar magnetic domain) плоский магнитный домен /ПМД/

PMGT (p-channel metal-gate transistor) р-канальный ПТ с металлическим затвором

PMJ (planar multijunction) планарный каскадный /солнечный элемент/

PMLC (pressed multi-layer cathode) прессованный многослойный матричный катод

PMMA (polymethylmethacrylate) полиметилметакрилат /фоторезист/

PMP (planar metallization with polymer) планарная металлизация с последующим нанесением пленки полимера

PMRAS (polarization modulation reflection-absorption spectroscopy)

спектроскопия отражения и поглощения излучения с модуляцией поляризации

PN (phosphorus nitride) нитрид фосфора

POSFET (piezoelectric-oxide-semiconductor FET)

ПТ со структурой пьезоэлектрик-окисел-полупроводник

PP (plasma polymerization) плазменная полимеризация

PPAC (parallel-plate avalanche counter) газоразрядный лавинный счетчик с параллельными пластинами

PPC (persistent photoconductivity) остаточная фотопроводимость

PPE (persistent photoconductivity effect) эффект остаточной фотопроводимости

PPE (photoplastic effect) фотомеханический /фотопластический/ эффект см. также PhPE

PPEM (parallel-plate electron multiplier)

электронный умножитель с параллельными пластинами /щелевого типа/

P²ES (photopyroelectric spectroscopy)
фотопирозлектрическая спектроскопия /исследование фазовых переходов/

PPM (periodic permanent magnet)
постоянный магнит с периодической структурой /фокусирующая система для ЛБВ/

PPTFE (plasma-polymerized polytetrafluoroethylene)
политетрафторэтилен, полученный плазменной полимеризацией

PR (photoresist)
фоторезист

PR (positive resist)
позитивный резист

PRA (prompt radiation analysis)
быстрый радиационный анализ /нейтронный активационный анализ/

PRD (proton recoil detection)
метод регистрации протонов отдачи /метод анализа материалов/

PRD (pinch-reflex diode)
пинчевый отражательный диод

PRE (pyroelectric)
пирозлектрик

PS (porous silicon)
пористый кремний

PS (planar stripe)
планарная полосковая структура

PSA (polysilicon self-alignment)
технология БИС на основе поликремния с самосовмещением

PSA (pattern shape adjustment)
технология с точным совмещением выводов эмиттера и базы /с использованием поликремния/

PSC (planar spark counter)
плоский искровой счетчик

PSD (photon-stimulated desorption)
фотостимулированная десорбция

PSD (polysilicon diode)
диод из поликристаллического кремния

PSEE (photo-stimulated exoelectron emission)
фотостимулированная экзoeлектронная эмиссия
см. также PEEE

PSES (polarized secondary-electron spectroscopy)
спектроскопия поляризованных вторичных электронов

PSID (planar-type self-magnetically insulated diode)
планарный диод с собственной магнитной изоляцией

PTB (pyroelectric-thermistor bolometer)
пирозлектрический термисторный болометр

PTIS (photothermal ionization spectroscopy)
фототермическая ионизационная спектроскопия

PTL (photostimulated thermoluminescence)
фотостимулированная термолюминесценция /ФТЛ/

PUCOT (piezoelectric ultrasonic composite oscillator technique)
метод составного пьезоэлектрического ультразвукового вибратора

PV (photovoltaic)
фотогальванический

PVAC (photovoltaically active)
фотогальванически-активный /полупроводник/

PVD (physical vapour deposition)
физическое осаждение из паровой фазы

PVD (plasma vapour deposition)
плазменное парофазное осаждение

p-well CMOS
КМОП структура с р-карманом

PWI (plasma-wall interactions)
взаимодействия плазмы со стенкой

PYS (photoemission yield spectroscopy)
спектроскопия квантового выхода фотоэмиссии

PZE (piezoelectric)
пьезоэлектрик

PZT (PbZrTi)
цирконат-титанат свинца /пьезокерамика/

Q

QC (quantum counter)
счетчик фотонов

QCM (quartz crystal microbalance)
микровесы на кварцевом вибраторе

Q1D (quasi-one-dimensional)
квази-одномерный /электронный газ/

Q2D (quasi-two-dimensional)
квази-двумерный /электронный газ/

QED (quantum electrodynamics)
квантовая электродинамика

QEL (quasi-Fermi level)
квазиуровень Ферми

Q-MAS (quadrupole mass analysis spectrometer)

см. QMS

QMOS (quick MOS)
быстродействующая МОП ИС
QMPA (quantitative microprobe analysis)
количественный микрозондовый анализ

QMS (quadrupole mass-spectroscopy)
квадрупольный масс-спектрометр
см. также Q-MAS

QSA (quadruple self alignment)
четырежды самосовмещение /в МОП технологии/

QSE (quantum size effect)
эффект размерного квантования /квантово-размерный эффект/

QUILP (quadruple-inline package)
корпус ИС с четырехрядным расположением выводов

QW (quantum well)
квантовая яма /размерное квантование/

QWH (quantum-well heterostructure)
гетероструктура с эффектом размерного квантования

QWS (quantum-well structure)
структура с квантово-размерным эффектом /с квантовыми ямами, СКЯ/

QWSCH (quantum-well separate confinement heterostructure)

гетеролазер с отдельным ограничением на структуру с квантово-размерным эффектом

R

R_oA (resistance-area)
произведение сопротивления /при нулевом смещении/ на площадь приемной поверхности фотоприемника

RAIR(S) (reflection absorption IR) spectroscopy)
см. RAIS

RAIS (reflection-absorption IR spectroscopy)

отражательно-абсорбционная спектроскопия ИК излучения
см. также RAIR(S)

RBDT (reverse-biased diode-thyristor)
диодный тиристор, запираемый по аноду

RBS (Rutherford back-scattering spectroscopy)
спектроскопия обратного резерфордского рассеяния быстрых ионов
см. также BRS

RCE (resonant coherent excitation)
резонансное когерентное возбуждение

RCT (reverse conducting thyristor)
тиристор с антипараллельными диодами

RDE (reactive deposition epitaxy)
реактивное эпитаксиальное
выращивание пленок /напр.,
силицидов/

RE (rare earth)
редкоземельный элемент

REB (relativistic electron beam)
релятивистский электрон-
ный пучок /РЭП/

RED (reflection electron diffraction)
дифракция отраженных эле-
КТронов

REG (relativistic electron gun)
релятивистская электрон-
ная пушка

REM (reflection electron microscope)
отражательный электронный
микроскоп

REM (reflection mode)
отражательный режим

RFA (retarding field analyzer)
энергоанализатор типа за-
держивающего потенциала

RFSEM (retarding field scanning electron microscope)
растровый электронный мик-
роскоп /РЭМ/ в режиме за-
держивающего потенциала

RG (residual gas)
остаточный газ /в ЭВП/

RGFET (recessed-gate FET)
полевой транзистор с за-

глубленным /скрытым/
затвором

RGSIT (recessed-gate SIT)
транзистор со статической
индукцией с заглубленным
/скрытым/ затвором

RHEED (row-angle HEED)
дифракция быстрых элект-
ронов, падающих под сколь-
зящим углом

RIA (rapid isothermal annealing)
быстрый изотермический
отжиг

RIC (radiation-induced conductivity)
проводимость, индуцирован-
ная облучением

R-ICB (reactive ionized cluster beam (deposition))
реактивное осаждение пле-
нок методом ионизирован-
ных кластеров

RIE (reactive-ion etching)
реактивное ионное травле-
ние

RIG (rare-earth iron garnet)
редкоземельно-железный
гранат

RIGD (refractive index to gain derivative)
производная показателя
преломления по усилению
/в оптических волноводах/

RIMS (resonance ionization mass-spectrometry)
резонансная ионизационная масс-спектрометрия /с лазерным возбуждением/

RIN (relative intensity noise)
относительная величина шума

RINS (rotating target neutron source)
источник нейтронов с вращающейся мишенью

RIP (reactive ion plating)

нанесение покрытий методом реактивного ионного распыления

RIS (radiation-induced segregation)
сегрегация, индуцированная облучением

RIS (resistor-insulator-semiconductor)
структура резистивный слой-диэлектрик-полупроводник /РДИП/

RIS (resonance ionization spectroscopy)
резонансная ионизационная спектроскопия

RLS (resonant light scattering)
резонансное рассеяние света

RMBE (reactive MBE)
реактивная молекулярно-лучевая эпитаксия

RMIS (refractory metal-insulator-semiconductor)
МДИП-структура с тугоплавким металлом

RM-MOSFET (relaxation-mode MOSFET)
МОП ПТ в режиме релаксации

RMPI (resonant multi-photon ionization)
резонансная многофотонная ионизация

ROGI (refilled oxide groove isolation)
изоляция повторным заполнением канавки окислом

ROS (resistor on sapphire)
резистивный слой на сапфире

RP (reverse photo-lithography)
обратная фотолитография

RPA (retarding potential analyzer)
энергоанализатор типа задерживающего потенциала

RPC (reduced pressure collapsing)
метод изготовления оптического волокна при пониженном давлении сжатия

RPE (relativistic photoelectrons)
релятивистские фотоэлектроны

RPP (reactive pulse plasma)
реактивная импульсная плазма

RS (Raman scattering)
комбинационное рассеяние
света /КРС/

RS (recoil spectro-
scopy)
спектроскопия атомов от-
дачи

RSAM (reflecting scann-
ing acoustic microscop)
растровый акустический
микроскоп в режиме отра-
жения

RSE (reactive sputter
etching)
травление реактивным рас-
пылением

RSR (relative spectral
response)
относительная спектраль-
ная чувствительность

RSR (resonance Raman
scattering)
резонансное комбинацион-
ное рассеяние

RTA (rapid thermal
annealing)
быстрый термический отжиг
см. также RTP

RTI (real-time indi-
cator)
индикатор в реальном
масштабе времени

RTN (rapid thermal
nitridization)
быстрое термическое нитри-
рование

RTP (rapid thermal
processing)
см. RTA

RVLSI (restructurable
VLSI)
СВИС с возможностью пере-
стройки функций

RWG (ridge-waveguide)
реберный волновод

RXRT (reflection X-ray
topography)
отражательная рентгеновс-
кая топография

S

SAC (self-aligned-
contact)
самосовмещенный контакт

SACSFET (sidewall-
assisted closely-spac-
ed electrode FET)
ПТ с близко расположенны-
ми электродами с использо-
ванием боковых стенок

SAD (selected area
diffraction)
микродифракция, дифракция
электронов от выбранной
области на изображении
/в просвечивающем элект-
ронном микроскопе/

SAD (small-angle
diffraction)
малоугловая дифракция

SADL (self-aligned
cell by DL-technique)
самосовмещенная структура
транзистора, сформирован-
ная с помощью повторного
процесса локального окис-
ления

SAE (surface anisotropic etch)

анизотропное травление поверхности

SAGM-APD (separate absorption, grading and multiplication APD)

лавинный фотодиод с раздельными областями поглощения, градиента состава и умножения носителей

SAINT FET (self-aligned implantation for n⁺-layer technology)
технология n⁺-канального ПТ с самосовмещением и ионной имплантацией

SALI (surface analysis by laser ionization)
поверхностный анализ методом лазерной ионизации

SALT (special air leak test)
воздушное течеискание

SAM (scanning Auger microprobe)
растровый оже-микроанализ

SAM (scanning Auger microscopy)
растровая оже-микроскопия

SAM (scanning acoustic microscopy)
растровая акустическая микроскопия

SAM-APD (separated absorption-multiplication APD)
лавинный фотодиод с раздельными областями опти-

ческого поглощения и умножения носителей

SAM-laser (single axial mode laser)
лазер с одной аксиальной модой

SANS (small-angle neutron scattering)
малоугловое рассеяние нейтронов

SAPCVD (sputter assisted plasma CVD)
химическое осаждение из паровой фазы с плазменным распылением

SAPS (self-aligned process by side-wall technology)
диффузионный процесс с самосовмещением с использованием боковых стенок

SAR MOS (self-aligned refractory MOS)
МОП ПТ с самосовмещенным затвором из тугоплавкого металла /Mo/

SAXS (small-angle X-ray scattering)
малоугловое рассеяние рентгеновского излучения

SBD (Schottky-barrier device)
прибор с барьером Шоттки

SBD (Schottky-barrier deflector)
оптический дефлектор с барьером Шоттки

SBF (Schottky barrier formation)
формирование барьера Шоттки

SBG-GEDD (Schottky-barrier-gate Gunn-effect digital device)
цифровой прибор на диоде
Ганна с затвором Шоттки

SBH (Schottky-barrier height)
высота барьера Шоттки

SBH (strip buried heterostructure)
скрытая меза-полосковая
структура

SBN ($\text{Sr}_{0,61}\text{Ba}_{0,39}\text{Nb}_2\text{O}_6$)
ниобат стронция-бария /СБН/
/сегнетоэлектрики/

SBR-laser (Schottky-barrier restriction laser)
лазерный диод с ограничением /тока/ барьером Шоттки

SBS (stimulated Brillouin scattering)
стимулированное бриллюэновское рассеяние

SBZ (surface Brillouin zone)
поверхностная зона Бриллюэна

SC (solar cell)
солнечный элемент

SC (simple cubic)
простая кубическая решетка

SCANIR (surface compositional analysis by neutral and ion impact radiation)
анализ поверхностного
состава путем спектро-

скопии ионостимулированного
излучения

SCC (short-circuit current)
ток короткого замыкания

SCC (short-coupled-cavity)
короткий связанный резонатор

SCC SML (short-coupled-cavity single-mode laser)
одномодовый лазер с коротким связанным резонатором

SCF (self-consistent field)
самосогласованное поле

SCH-laser (separate-confinement heterostructure laser)
гетеролазер с разделением /электрическим и оптическим/ ограничением /РО/

SCIC (semi-custom IC)
полузаказная интегральная микросхема

SCL (space charge layer)
слой пространственного заряда

SCL (space-charge limited)
/транзистор/ в режиме ограничения тока пространственным зарядом

SCLA (symmetric coupled laser array)
матрица лазерных диодов с симметричными связями

SCLC (space-charge limited current)
ток, ограниченный пространственным зарядом

SCM (scanning cathodoluminescence microscopy)
растровая катодолюминесцентная микроскопия

SCM (scanning capacitance microscopy)
растровая емкостная микроскопия

SC MOS (short-channel MOS)
планарный МОП ПТ с коротким каналом

SC MOSFET (Schottky-clamped MOSFET)
МОП ПТ с фиксирующим /демпфирующим/ диодом Шоттки

SCPT (Schottky-collector phototransistor)
фототранзистор с коллекторным барьером Шоттки

SCR (space-charge region)
область пространственного заряда /ОПЗ/

SCRIBE process (subnanometer cutting and ruling by an intense beam of electrons)
резка и разделение /подложек/ интенсивным электронным лучом сечением < 1 нм /скрайбирование/

SCTJ (surface-channel tunnel junction)
туннельный переход с поверхностным каналом

SD (Si-doped)
легированный кремнием

SD (sputter deposition)
осаждение пленок методом катодного распыления

SDA (spherical deflector analyzer)
сферический отклоняющий энергоанализатор

SDHT (selectively-doped heterotransistor)
селективно-легированный гетеротранзистор

SDP (sputter depth profile)
глубинное профилирование с применением ионного распыления

SDS (semiconductor-dielectric-semiconductor)
см. SIS

SDT (sputter deposition technique)
метод нанесения пленок распылением

SE (secondary electron)
вторичный электрон

SE (solvent evaporation)
процесс напыления растворителя /проявление фоторезиста/

SE (spectroellipsometry)
спектроэллипсометрия

SE(L) (surface emitting laser)
см. SELD

SEBL (scanning electron-beam lithography)
растровая электронолитография

SEC (secondary electron conductivity)
вторично-электронная /наведенная/ проводимость

SECS (solar energy conversion system)
система преобразования солнечной энергии

SEE (secondary electron emission)
вторично-электронная эмиссия

SEED (self-electro-optic-effect device)
оптоэлектронный прибор с собственным электрооптическим эффектом

SEES (secondary electron emission spectroscopy)
вторично-электронная спектроскопия
см. также SES

SEG (selective epitaxial growth)
селективная эпитаксия

SEI (secondary electron imaging)
изображение во вторичных электронах

SEI (selective epitaxial isolation)
изоляция методом селективной эпитаксии

SELD (surface-emitting laser diode)
лазерный диод с поверхностным излучением
см. также SE(L)

SELOX (selective oxidation)
селективное окисление

SEM (secondary-electron multiplier)
вторично-электронный умножитель /БЭУ/

SEM=EBIC
растровый электронный микроскоп в режиме наведенного тока

SEP (selective epitaxial planar process)
планарная технология с использованием селективной эпитаксии

SEPHD (single-electron pulse-height distribution)
одноэлектронное амплитудное распределение

SEPI (short excitation and prolonged interrogation)
метод короткого возбуждения и длительного опроса /в спектроскопии комбинационного рассеяния с временным разрешением/

SEPOS (self-defined polysilicon sidewall)
технология ИС с самоог-

раничивающей поликремниевой изоляцией боковой стенки

SER (short external resonator)

короткий внешний резонатор

SER MOSFET (sputter-etched refractory MOS FET)

полевой МОП транзистор с затвором, сформированным из тугоплавкого металла путем ионного травления

SERS (surface-enhanced Raman scattering)

усиленное поверхностью комбинационное рассеяние

SES (secondary-electron spectroscopy)

см. SEES

ESCA (scanning ESCA) растровая электронная спектроскопия для химического анализа

SEXAFS (surface EXAFS) поверхностная спектроскопия тонкой структуры протяженных спектров рентгеновского поглощения

SF (stacking faults) дефекты упаковки

SFET (surface FET) поверхностный полевой транзистор

SFM (split-field magnet) целевой магнит

SFR(L) (spin-flip Raman laser)

перестраиваемый лазер на комбинационном рассеянии с обращением спина

SGRPA (spherical-grid retarding potential analyzer)

энергоанализатор типа задерживающего потенциала со сферическими сетками

SG-silicon (semiconductor-grade si) кремний полупроводникового качества

SGSIT (surface-gate SIT)

транзистор со статической индукцией с поверхностным затвором

SHEED (scanning HEED)

сканирующий метод дифракции быстрых электронов

SHG (second harmonic generation)

/нелинейная оптическая среда/ с генерацией второй гармоники

SI (semi-insulating) полуизолирующий

SIA (surface and interface analysis)

анализ поверхностей и границ раздела

SIB (showered ion beam)

нефокусированный пучок ионов /для ионной имплантации и ионного травления/

SIBL (scanning ion-beam lithography)

растровая ионолитография

SICOS (side-wall-base contact structure)

структура с боковым контактом базы

SID (semiconductor imaging device)

полупроводниковый преобразователь изображения

SIES (sputtering-induced emission spectroscopy)

спектроскопия оптического излучения, индуцированного распылением

см. также SIPS

SIGFET (semi-insulated-gate FET)

полевой транзистор с полужолированием затвором

SiG MOS (Si-gigabit=SiN MOS)

кремниевая n-МОП ИС, обеспечивающая передачу информации со скоростью ~ Гбит/с

SIIMS (secondary ion imaging mass-spectrometer)

вторично-ионный микроскоп-масс-анализатор

SIIP (spectroscopy of ion-induced photons)

спектроскопия ионостимулированного излучения

SILO (sealed interface local oxidation)

межэлементная изоляция локальным прокислением

эпитаксиального слоя до подложки

SIM (scanning ion microscope)

растровый ионный микроскоп

SIMIS (stepped insulator MIS)

МДП структура со ступенчатым профилем изолятора

SIMMWIC (silicon millimeter-wave IC)

кремниевая ИС миллиметрового диапазона волн

SIMOX (separation by implanted oxygen)

окисная изоляция имплантацией ионов кислорода в кремний

SIMS (secondary-ion mass-spectrometry)

вторично-ионная масс-спектрометрия /ВИМС/

SIOV (Siemens oxide-metal varistor)

варистор со структурой металл-оксид фирмы Сименс

SIP (sputter ion plating)

нанесение покрытий методом ионного распыления

SIPS (sputter-induced photon spectroscopy)

см. SIES

SIPT (static induction phototransistor)

фототранзистор со статической индукцией /СИФТ/

SIPT(hy) (static induction photothyristor)
фототиристор со статической индукцией

SIRIS (sputter-initiated resonance ionization spectroscopy)
резонансная ионизационная спектроскопия при распылении

SIS (semiconductor-insulator-semiconductor)
структура полупроводник-диэлектрик-полупроводник /ПДП/
см. также SDS

SISFET (semiconductor-insulator-semiconductor FET)
полевой транзистор с ПДП структурой /ПДП-ПТ/

INFET (Schottky injection FET)
ПТ с инжекцией неосновных носителей через барьер Шоттки

SITHy (static induction thyristor)
тиристор со статической индукцией

SJ (shallow junction)
мелкий переход

SJT (semiconductor junction transistor)
полупроводниковый плоскостной биполярный транзистор

SL (slave laser)
связанный лазер с инжекционным затвором /с внешним запуском/

SL (superlattice)
сверхрешетка

SLEB (swept-line electron beam) annealing
отжиг сканирующим электронным лучем

SLEEP (scanning low energy electron probe)
сканирующий электронный зонд с низкой энергией

SLM (scanning laser microscope)
растровый лазерный микроскоп

SLM (single longitude mode) operation
режим одной продольной моды

SLP (single-layer polysilicon)
однослойное поликремниевое покрытие

SLPT (super-linear power transistor)
мощный сверхлинейный транзистор

SL-QWH (strained-layer quantum-well heterostructure)
напряженная гетероструктура с квантоворазмерным эффектом

SLS (strained-layer superlattice)
см. SSL

SMA (spherical mirror analyzer)
сферический зеркальный энергоанализатор

SMA (surface mounted assembly)
сборка с поверхностным монтажом

SMC (surface mounted component)
элемент с поверхностным монтажом

SMCP (single MCP)
одиночная микроканальная пластина /с изогнутыми каналами/

SMD (surface-mounted device)
прибор с поверхностным монтажом

SMG (substrate-mesa-guide)
волноводная меза-структура в подложке

SMIS (surface MIS)
МДП структура с поверхностным каналом

SML (single-mode laser)
одномодовый лазер

SMMW (submillimeter-wave)
субмиллиметровый диапазон волн

SMOS (submicrometer-channel MOS)
субмикронная МОП ИС

SMT (surface mounting technology)
технология поверхностного монтажа

SNMS (secondary neutrals mass-spectrometry)
масс-спектрометрия вторичных нейтральных атомов

SNMS (sputtered neutrals mass-spectrometry)
масс-спектрометрия распыленных атомов /в высокочастотной плазме/

SNR (signal-to-noise ratio)
отношение сигнала к шуму

SNR (silicone-based negative resist)
негативный резист на силиконовой основе

SNS-JJ (superconductor-normal-superconductor Josephson junction)
переход Джозефсона со структурой сверхпроводник-нормальный проводник-сверхпроводник

SOC (Si-on-ceramic)
кремний на керамике

SOF (Si-on-fabric)
кремний на ткани

SOG (spin on glass)
/планаризация/ загонкой стеклянной фритты

SOGICON (semiconductor oscillation generator by injection and constriction)
полупроводниковый генератор на принципе инжекции и сжатия

SOLID (silicide-on-lightly-doped-drain)
МОП ПТ со слоем силицида на слабелегированном стоке /в целях уменьшения паразитного сопротивления сток-исток/

SOM (scanning optical microscopy)
растровая оптическая микроскопия

SOP (small outline package)
малогобаритный корпус

SOR (synchrotron optical radiation)
оптическое излучение синхротрона
см. также SR (synchrotron radiation)

SPAD (single-photon avalanche diode)
лавинный фотодиод с однофотонным разрешением

SPC (semitransparent photocathode)
полупрозрачный фотокатод

SPD (selfscanned photodiode)
самосканирующая фотодиодная матрица

SPD (Si-photodiode)
кремниевый фотодиод

SPDA (silicon photodiode array)
кремниевая фотодиодная матрица

SPE (solid phase epitaxy)
твердофазная эпитаксия

SPIEI-laser (separately pumped integrated etalon interference laser)

эталонный лазер со встроенным интерферометром и отдельной накачкой

SPIPES (spin-polarized inverse photoemission spectroscopy)

спектроскопия тормозного излучения, возбужденного спинполяризованными электронами

SPO (surface plasma oscillations)
поверхностные плазмоны

SPRITE (signal processing in the element)
матричный приемник изображения с преобразованием сигнала внутри элемента /в режиме временной задержки и накопления/
см. также TDI, TED

SPS (space-use solar cell)
солнечный элемент для использования в космосе

SPS (synchrotron-radiation induced photoemission spectroscopy)
см. SRPES

SQS (self-quenching streamer)
самогасящийся стример

SQW (single quantum well)
одиночная квантовая яма
см. также SW

SQW FET (strained-quantum well FET)
ПТ на основе напряженной сверхрешетки

SQWT (single quantum-well transistor)
структура транзистора с одиночной квантовой ямой

SR (space-resolved)
с пространственным разре-
шением

SR (synchrotron radiation)
синхротронное излучение
см. также SOR

SRO (short-range
order)

ближний порядок /атомная
корреляция в пределах пер-
вых атомных оболочек/

SRO (stress relief
oxide)

напряженная рельефная
пленка окисла на поверх-
ности кремния /напряжения,
связанные с рельефом окис-
ной пленки/

SRP (spreading-resis-
tance probe)

зонд распределенного со-
противления

SRP (spreading resis-
tance profiling)

метод контроля материала
по профилю распределенно-
го сопротивления

SRPES (synchrotron ra-
diation photoemission
spectroscopy)

фотоэлектронная спектро-
скопия с возбуждением
синхротронным излучением
см. также SPS

SRPL (spatially-resolv-
ed photoluminescence)

метод фотолюминесценции
с пространственным разре-
шением

SRS (stimulated Raman
scattering)
стимулированное комби-
национное рассеяние

SRS (synchrotron radia-
tion source)
источник синхронного из-
лучения

SS (solid state)
твердое тело

SS (stainless-steel)
нержавеющая сталь

SS (surface states)
поверхностные состояния

SSA (self-scanned
array)
самосканирующая матрица

SSBH (self-aligned
strip buried hetero-
structure)
скрытая самосовмещенная
полосковая гетероструктура

SSC (source current
control)
способ введения примеси
в эпитаксиальную пленку
путем регулирования тока
через источник

SSCH-laser (stepped
separate-confinement
heterostructure laser)

лазерный диод со ступен-
чатой гетероструктурой
с отдельным ограничением

SSD (solid state
detector)
твердотельный детектор
/ионизирующих излучений/

SSD (synthesis solute-diffusion)	SSS (slow surface states)
метод выращивания /монокристаллов/ из раствора в расплаве по схеме синтеза-диффузия	медленные поверхностные состояния
S^2 DHT (superlattice selectively-doped heterotransistor)	SST (sealed sidewall trench)
селективно-легированный гетеротранзистор со сверхрешеткой	бездефектная изоляция заполненными канавками в боковой стенке
SSE (separate-source evaporation)	SST (small-sized transistor)
испарение из отдельных источников	малоразмерный транзистор /элемент ИС/
SSEM (stroboscopic SEM)	SST (super self-align technology)
РЭМ в режиме стробирования	технология самосовмещения с высокой точностью
SSIMS (static SIMS)	SSTWA (solid-state travelling-wave amplifier)
статическая вторично-ионная масс-спектрометрия	твердотельный усилитель бегущей волны
SSL (strained superlattice)	STM (scanning tunneling microscopy)
напряженная сверхрешетка см. SLS	растровая туннельная микроскопия
SSNTD (solid-state nuclear track detector)	STPV (solar thermophotovoltaic) cell
твердотельный детектор треков ядерных частиц	термо-фотогальванический солнечный элемент
SSP (scanning surface photovoltage) technique	STRS (stimulated thermal Rayleigh scattering)
анализ поверхностного фотонапряжения со сканированием	термостимулированное рэлеевское рассеяние
SSR (solid-state recrystallization)	STXM (scanning transmission X-ray microscopy)
рекристаллизация	растровая просвечивающая рентгеновская микроскопия

SUS (substrate-graded stainless steel)

подложка из нержавеющей стали высокого качества /с зеркально отражающей поверхностью/

SV (silicon vidicon) видикон с кремниевой мишенью /кремникон/

SW (single well) см. SQW

SWAMI (side-wall-masked isolation) метод изоляции боковыми стенками

SWI (semi-well isolation) полуглубинная изоляция /путем диффузии в часть эпитаксиального слоя/

SWIR (short-wave IR) коротковолновая ИК область спектра

SWO (single-wavelength operation) одномодовый режим

SWS (slow-wave structure) замедляющая система

SXA (soft X-ray absorption spectroscopy) спектроскопия поглощения мягкого рентгеновского излучения

SXAPS (soft X-ray appearance potential spectroscopy) спектроскопия потенциалов появления мягкого рентгеновского излучения

SXDA (soft X-ray emission depth profile analysis)

глубинное профилирование с использованием мягкого рентгеновского излучения

SXE (soft X-ray emission) мягкое рентгеновское излучение см. также SXR

SXES (soft X-ray emission spectroscopy) спектроскопия мягкого рентгеновского излучения

SXM (scanning X-ray microscopy) растровая рентгеновская микроскопия

SXPS (soft-X-ray photoemission spectroscopy) фотоэлектронная спектроскопия при возбуждении мягким рентгеновским излучением

SXR (soft X-ray) см. SXE

T

TAC (thermal accommodation coefficient) коэффициент термической аккомодации /газов/

TAEM (transmission analytical electron microscopy) аналитическая просвечивающая электронная микроскопия

TAP (tape automated bonding)
автоматизированная прикле-
йка /элементов ИС/ на ленту

TAV (transverse acous-
toelectric voltage)
поперечное акустоэлектри-
ческое напряжение

TB (tunable birefrin-
gence)
перестраиваемое двойное
лучепреломление

TBP (triangular-barrier
photodiode)
фотодиод с треугольным
/потенциальным/ барьером

TC (transistor cell)
транзисторная ячейка

TCBC-laser (three-
channel buried-crescent
laser)
трехканальный лазерный
диод со скрытой серповид-
ной активной областью

TCC (transparent con-
ductive coating)
прозрачное проводящее по-
крытие
см. также CTC

TCDS (tandem cylind-
rical deflector spect-
rometer)
сдвоенный цилиндрический
отклоняющий спектрометр

TCE (thermal coefficient
of expansion)
см. TEC

TCL (transparent con-
ductive layer)
прозрачный проводящий
слой

TCL (twin channel
laser)
двухканальный лазерный
диод

TCM (thermal conduc-
tion module)
теплопроводящий керами-
ческий модуль /для кор-
пусов ИС/

TCO (transparent con-
ductive oxide)
прозрачный проводящий оки-
сел

TCS (total current
spectroscopy)
спектроскопия полного
тока

TCSM (twin-channel-
substrate mesa-guide)
меза-полосковая структу-
рой с двойным каналом в
подложке

TD (thermal diffusion)
термодиффузия

TD (thermal donor)
термодонор

TD (thermodesorption)
см. TSD

TDH-laser (twisted
double heterostructure
laser)
двойной гетеролазер с за-
крученной активной об-
ластью
см. также TDS

TDI (time-delay-integ-
ration)
режим временной задержки
и накопления /ВЗИ/
см. также SPRITE, TED

TDL (tunable diode laser)
перестраиваемый диодный лазер

TDMCVP (temperature difference method under controlled vapour pressure)

выращивание методом разности температур при регулируемом давлении пара

TDMS (thermal desorption mass-spectrometry)
термодесорбционная масс-спектрометрия

TDS (thermodesorption spectroscopy)
термодесорбционная спектроскопия

TDS (twisted double heterostructure)
см. TDH

TE-cooled (thermo-electricity cooled)
с термоэлектрическим охлаждением

TEA (tunnel-emission amplifier)
усилитель на туннельной эмиссии

TEA-CO₂-laser (transverse-excited atmospheric CO₂ laser)
лазер на CO₂ с атмосферным давлением с поперечным возбуждением

TEC (thermal expansion coefficient)
коэффициент термического расширения
см. также TCE

TEC (thermionic energy converter)
термоэмиссионный преобразователь энергии /ТЭП/

TED (Tom Elliot detector)
см. TDI, SPRITE

TED (total energy distribution)
распределение по полным энергиям

TED (transmission electron diffraction)
дифракция электронов в просвечивающем режиме

TEG(a) (triethyl-gallium)
триэтилгаллий

TEG (two-dimensional electron gas)
двумерный электронный газ
см. также 2DEG, 2D-E

TEG FET (two-dimensional electron gas FET)
ПТ с двумерным электронным газом /на гетероструктуре с затвором Шоттки/

TEI(n) (triethyl-indium)
триэтилиндий

TELEC (thermoelectronic laser energy converter)
термоэлектронный преобразователь энергии лазерного излучения

TELIP (temperature-limited infrared photo-detector)
приемник ИК излучения в

режиме ограничения тепловым шумом

TELS (transmission energy loss spectroscopy) спектроскопия потерь энергии /электронов/ в просвечивающем режиме

TEME (thermo-electromotive force) термо-э.д.с.

TEN₂-laser (transverse-excited N₂ laser) азотный лазер с поперечным возбуждением

TESS (thermal expansion shear separation) разделение слоев с использованием разности термического расширения

TFE (thermionic-field emission) термостимулированная автоэлектронная эмиссия /автотермоэмиссия/

TFEG (tetrode field-emission gun) тетродная электронная пушка с автоэмиссионным катодом

TFEL (thin-film electroluminescent) тонкопленочный электролюминесцентный /излучатель/

T-FET (T-gate structure FET) ПТ с затвором Т-образной формы

TGD (thermally-generated defect)

термически генерированный дефект

TG LPE (temperature gradient LPE) жидкофазная эпитаксия с температурным градиентом

TGM (toroidal grating monochromator) монохроматор с тороидальной дифракционной решеткой

TNB (temperature-humidity-bias) испытания в режиме повышенных температуры-влажности-смещения

THEED (transmission HEED) дифракция быстрых электронов в просвечивающем режиме

THG (two-dimensional hole gas) двумерный дырочный газ см. также 2DHG, 2D-H

THM (travelling heater method) метод движущегося нагревателя /зонного растворения/ при выращивании кристаллов из раствора в расплаве

TIL GTO (two interdigitation levels GTO) двухоперационный триодный тиристор с двойной встречно-штыревой конструкцией

TIP (trench isolation process) технология ИС с изоляцией

канавками /вместо локального окисления KHC/

TJC (tandem-junction cell)

сдвоенный /двухпереходный/ элемент

TJS (transversal-junction strip)

поперечный полосковый переход

см. также TS

TLD (thermoluminescent dosimeter)

термолюминесцентный дозиметр

TLR (tri-level resist)
трехслойное маскирование

TLW (three-layer-waveguide)

трехслойный волновод

TMG (trimethyl-gallium)

триметилгаллий

TMI (trimethylindium)
триметилиндий

TMOS (trench MOS)

МОП структура с затвором в канавке прямоугольной формы

TMP (turbomolecular pump)

турбомолекулярный вакуумный насос

TN (twisted nematic)
скрученный нематик

TOF (time of flight)
времяпролетный

TOFA (time-of-flight analysis)

времяпролетный метод анализа

TOFAP (time-of-flight atom probe)

времяпролетный атомный зонд

TOFISS (time-of-flight ion scattering spectrometer)

времяпролетный спектрометр рассеянных ионов

TOFMS (time-of-flight mass-spectrometer)

времяпролетный масс-спектрометр

TOK (transverse optical klystron)

поперечный оптический клистрон

TOM (temperature oscillating method)

метод осциллирующей температуры /выращивания монокристаллов в вертикальной печи/

TOPMOST (Toshiba program MOS transistor)

МОП транзистор, изготовленный по программе фирмы Тосиба

TPC (time projection chamber)

времяанализирующая камера

TPD (temperature-programmed desorption)

температурно-программируемая десорбция

TPRS (two-photon Raman scattering)
двухфотонное комбинационное рассеяние

TPV (thermophotovoltaic)
термофотогальванический /эффект/

TR (time-resolved)
с временным разрешением

TR EELS (time-resolved EELS)
спектроскопия энергетических потерь электронов с временным разрешением

TRIMOS (triac MOS)
МОП-триак /МОП тиристор с симметричной характеристикой/

TRLIF (time-resolved laser-induced fluorescence)
спектроскопия возбужденной лазером флуоресценции с временным разрешением

TRS (thermoreaction spectroscopy)
термореакционная спектроскопия

TRS (time-resolved spectroscopy)
спектроскопия с временным разрешением

TRS-laser (twin-ridge substrate laser)
лазерный диод с двойным ребром в подложке

TS (terraced substrate)
террасированная подложка

TS (transversal-junction strip)
см. TJS

TSB (trenched Schottky barrier)
барьер Шоттки, сформированный в канавке

TSC (thermally stimulated conductivity, current)
термостимулированная проводимость /ток/

TSCAP (thermally stimulated capacitance)
термостимулированная емкость

TSD (thermally stimulated desorption)
термостимулированная десорбция /термодесорбция/

TSD (thermally stimulated discharge)
термостимулированный разряд

TSDS (tandem spherical deflector spectrometer)
сдвоенный сферический отклоняющий спектрометр

TSE (thermostimulated exoemission)
см. TSEE

TSEE (thermally stimulated exoelectron emission)
термостимулированная экзoeлектронная эмиссия
см. также TSE

TSEM (transmission secondary electron multiplier)

электронный умножитель
с прострельными диодами

TSFZ (travelling
solvent floating zone)
см. TSM

TSI (titanic-scale
integration)
сверхвысокая степень инте-
грации /СВИС/

TSIC (thermally stimu-
lated ionic current)
термостимулированный ион-
ный ток

TSL (thermally stimu-
lated luminescence)
термостимулированная лю-
минесценция, термолюми-
несценция

TSM (thermally stimu-
lated current and ca-
pacitance measurements)
измерение термостимулиро-
ванных тока и емкости

TSM (travelling solvent
method)
зонная плавка с темпера-
турным градиентом
см. также TSFZ

TSN-LED (transparent-
substrate-nitride
light-emitting diode)
светодиод на прозрачной
просветленной нитридом
кремния подложке

TSSG (top-seeded so-
lution growth)
вытягивание /кристалла/
на затравку из раствора
в расплаве

TTED (transit-time
effect device)
прибор на основе пролет-
ного эффекта

TTT (two-terminal
thyristor)
двухполюсный тиристор пе-
реключатель

TTWT (transverse-beam
TWT)
лампа бегущей волны с по-
перечным лучом

TUNNETT (tunnel-injec-
tion transit-time)
туннельный инжекционно-
пролетный диод

TWA (travelling-wave
amplifier)
см. TWTA

TWF (travelling-wave
FET)
полевой транзистор с бе-
гущей волной /длинная
структура с распределен-
ными параметрами/

TWK (travelling-wave
klystron)
клистрон бегущей волны
TWP (travelling-wave
phototube)
фото-ЛБВ

TWR (travelling-wave
resonator)
резонатор бегущей волны

TWT (travelling-wave
tube)
лампа бегущей волны /ЛБВ,
TWT (L) (travelling-
wave type laser)
лазер бегущей волны

TWT DHL (travelling-wave type double heterostructure laser)
двойной гетеролазер бегущей волны

TWTA (travelling-wave tube amplifier)
усилитель на ЛБВ
см. также TWA

TXRT (transmission X-ray topography)
просвечивающая рентгеновская топография

U

UBIS (ultraviolet bremsstrahlung isochromat spectroscopy)
спектроскопия изохроматического тормозного УФ излучения /электрон-фотонная спектроскопия/
см. также BIS, IPES, IPE

UCBF (undercut and backfill)
техника подтрав и заполнения /изоляция/

UCP (ubiquitous crystallization process)
стандартный /обычный/ процесс кристаллизации

UDT (unidirectional transducer)
однонаправленный преобразователь ПАВ

UHVA (ultrahigh-vacuum arc)
сверхвысоковакуумный дуговой разряд

U-ISO (U-groove isolation)
изоляция U-образной канавкой

ULISYS (ultrasonic imaging system)
ультразвуковая система отображения

UMOS (U-groove MOS)
полевой МОП транзистор с U-образной канавкой

UPBI (U-grooved PBT)
транзистор с проникаемой базой с U-образной канавкой

UPS (UV-photoemission spectroscopy)
УФ фотоэлектронная спектроскопия /УФЭС/

UVC (UV-to-visible converter)
преобразователь УФ излучения в видимое

UVEPROM (ultraviolet-erasable PROM)
программируемое ПЗУ со стиранием УФ облучением

UVLSI (ultra-very-large scale integration)
сверхвысокая степень интеграции /СВИС/

V

VACL (vacuum arc current limited)
режим, ограниченный током вакуумного пробоя

VB (valence band)
валентная зона

VBDOS (valence band density of states)
плотность состояний в валентной зоне

VBM (valence band maximum)
вершина валентной зоны

VBS (variband structure)
варизонная структура

VBT (valence band top)
вершина валентной зоны

V-CCD (vertical CCD)
ПЗС /со скрытым каналом/
с вертикальной организацией

VCNR (voltage-controlled negative resistance)
отрицательное сопротивление, регулируемое напряжением

VD²MOSFET (vertical double-diffused dual-gate MOSFET)

двухзатворный МОП ПТ с вертикальной геометрией, изготовленный методом двойной диффузии

VDI MOS (vertical double-implanted MOS)
МОП транзистор с вертикальной геометрией, изготовленный методом двойной ионной имплантации

VDP (vacuum deposition)
вакуумное осаждение

VDP (Van der Pauw)
теория /приближение/ Вандер-Пау

VEELS (vibrational electron energy loss spectroscopy)

колебательная спектроскопия потерь энергии электронов

VHEED (very high energy electron diffraction)

дифракция очень быстрых электронов

VIC (vacuum integrated circuit)

вакуумная интегральная микросхема

VIDIC (visible-to-IR dynamic image converter)

динамический преобразователь видимого изображения в ИК /на основе жидкокристаллической светоклапанной панели/

VIPS-laser (V-grooved inner-strip on pInP substrate laser)

лазерный диод с встроенной полосковой активной областью в V-образном канале в pInP подложке

VIST (vertically isolated self-aligned transistor)

транзистор с самосовмещенным затвором с изоляцией по вертикали

VLEED (very low energy electron diffraction)

дифракция очень медленных электронов

VLPE (vapour-liquid phase epitaxy)
гибридная парофазная-жидкофазная эпитаксия

VMCP (2 MCP in V-cascade)
шеvronное соединение 2 микроканальных пластин

VOD (vertical overflow drain)
вертикальный сток переполнения /в ПЗС с межстрочным или строчно-кадровым переносом/

VP CCD (virtual-phase CCD)
ПЗС с виртуальной фазой

VPE (vapour-phase etching)
парофазное травление

VPO (vapour-phase oxidation)
поверхностное окисление из паровой фазы

VPR (vapour-phase regrowth)
парофазное разращивание

VPS (vacuum plasma spraying)
плазменное струйное распыление в вакууме

VPTBH (vapour-phase transported buried heterostructure)
скрытая гетероструктура, полученная методом парофазного транспорта

VSB-laser (V-grooved substrate buried laser)
лазерный диод со скрытой структурой с V-образным каналом в подложке

VSIS-laser (V-channelled substrate inner stripe laser)
лазерный диод с встроенным V-образным полосковым каналом в подложке

VUV (vacuum ultra-violet)
вакуумный ультрафиолет /ВУФ/

VVC (voltage-variable capacitor)
варактор

W

WF (work function)
работа выхода

WHO (wet hydrogen oxidation)
окисление в атмосфере влажного водорода /при изготовлении СБИС с W-защитом во избежание окисления W/

X

XAES (X-ray-excited Auger electron spectroscopy)
электронная оже-спектроскопия с рентгеновским возбуждением

XAFS (X-ray absorption fine structure)
тонкая структура спектров рентгеновского поглощения

XANES (X-ray absorption near-edge structure)
структура спектра краевого рентгеновского поглощения

XAS (X-ray absorption spectroscopy)
спектроскопия рентгеновского поглощения /адсорбционная спектроскопия/

XD (X-ray diffraction)
см. XRD

XEDS (X-ray-energy dispersive spectroscopy)
рентгеновская энергодисперсионная спектроскопия

XES (X-ray emission spectroscopy)
спектроскопия рентгеновского излучения

XMOS-transistor
ПТ с двумя затворами с дополняющими каналами на каждой поверхности рекристаллизованного слоя поликремния /для снижения эффекта короткого канала/
см. также Cross MOS

XO (quartz crystal oscillator)
кварцевый вибратор
см. также CO

XPD (X-ray photoelectron diffraction)

дифракция рентгеновских фотоэлектронов

XRA (X-ray absorption)
рентгеновское поглощение

XRD (X-ray diffraction)
рентгеновская дифракция
см. также XD

XRDS (X-ray diffuse scattering)
диффузное рассеяние рентгеновского излучения

XRF (X-ray fluorescence)
рентгеновская флуоресценция

XRL (X-ray lithography)
рентгенолитография

XRM (X-ray microscopy)
рентгеновская микроскопия

XRT (X-ray topography)
рентгеновская топография

XCWIS (X-ray standing wave interference spectrometry)
спектроскопия интерференции стоячих волн рентгеновского излучения /метод анализа адсорбционных систем/

XTEM (cross-sectional TEM)
просвечивающий электронный микроскоп в режиме секционного исследования /образцов с косым сечением/

XUV (X-ray-UV region, extreme UV)
диапазон спектра между

УФ и рентгеновским излу-
чением /с длиной волны
1,5 - 20 нм/

Y

YS (yield spectroscopy)
спектроскопия /квантового/
выхода

YSZ (yttria-stabilized
zirconic)
двуокись циркония, стаби-
лизированная окисью иттрия

Z

ZD (zener diode)
стабилитрон

ZM (zone melting)
зонная плавка

ZMCP (3-4 MCP in
cascade)
Z-образное шевронное сое-
динение 3-4 микроканаль-
ных пластин /сборка МКП
с Z-конфигурацией/

ZMR (zone-melting
recrystallization)
рекристаллизация зонной
плавкой

ZO (zinc oxide)
оксид цинка /прозрачное
проводящее покрытие/

ZR (zone-refining)
зонная очистка

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РУССКИЕ АББРЕВИАТУРЫ:

ЗУ	запоминающее устройство
ЗУПВ	ЗУ с произвольной выборкой
ИК	инфракрасный
ИС	интегральная микросхема
КМОП	комплементарная МОП-структура
КНС	кремний-на-сапфире
ЛБВ	лампа бегущей волны
ЛПД	лавинно-пролетный диод
МАП	структура металл- Al_2O_3 -полупроводник
МДП	металл-диэлектрик-полупроводник
МДПДМ	металл-диэлектрик-полупроводник- диэлектрик-металл
МНОП	металл-нитрид кремния-окисел- полупроводник
МОНОП	металл-окисел-нитрид кремния-окисел- полупроводник
МОП	металл-окисел-полупроводник
МКП	микроканальная пластина
ПАВ	поверхностная акустическая волна
ПЗС	прибор с зарядовой связью
ПТ	полевой транзистор
РЭМ	растровый электронный микроскоп
СВЧ	сверхвысокая частота
ЭЛТ	электронно-лучевая трубка
ЭОП	электронно-оптический преобразователь
ЭПР	электронный парамагнитный резонанс
УФ	ультрафиолетовый

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
От составителей	3
Английские сокращения и их русские эквиваленты	4
Использованные русские аббревиатуры ..	110

Нина Александровна СОБОЛЕВА,
Ираида Петровна ВИШНЕВСКАЯ

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРАМ

Под редакцией канд.физ.-мат.наук С.Х. Батыгова

Редактор Г.Ф. Баталова

Технические редакторы Г.М.Аристова,
Н.К. Дудова

Корректор В.М. Фадеева

Подп. в печать 13.06.86. Формат 60х84/16. Бум.офс.№2.
Печ. офсетная. Усл.печ.л. 6,51. Усл.кр.-отт. 6,70.
Уч.-изд.л. 5,28. Тираж 3000 экз. Заказ №4970 Цена 1 р.

Всесоюзный центр переводов научно-технической
литературы и документации

117218, Москва В-218, ул. Кржижановского, д.14, к.1

ПИК ВИНТИ, 140010, Моск, обл., Октябрьский просп., 403

Англ. сокр. по электрон. приборам, 1986, 1—112